بسم الله الرحمن الرحیم

عایق ها و فشار قوی

مدرس: دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض

نیم سال اول ۹۰-۱۳۸۹

دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی

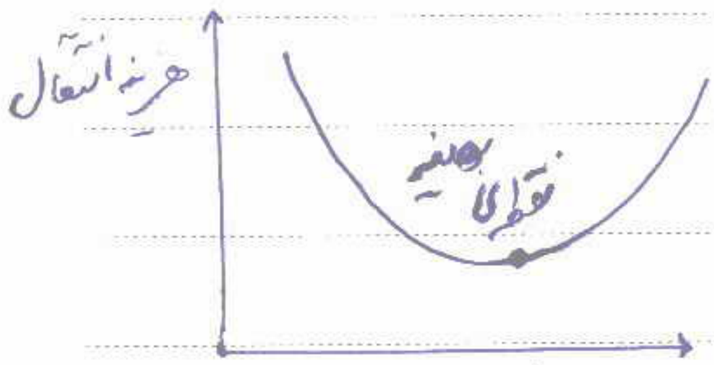
گروه مهندسی برق

Subject: 1

Year. Month. Date. ( )

1. High Voltage Engineering. Fundamentals $\xrightarrow{by}$ Kuffel, Zaengl

۲. دانشگاه تهران - دکتر محسنی - مهندسی فشار قوی



باید تجهیزات را از نظر اینکه کل ولتاژهای بالا را دارند یا ندارند بررسی کرد.

۱. سطح عایقی را با شدت صدایی که می‌تواند تحمل کند بررسی می‌کنند.

۲. این عایق باعث کم شدن تحمل خواهد شد چون روی میدان ها تأثیرات نامطلوبی می‌گذارد.

الکترود

۱. باید بتوان ولتاژهای بالا تولید کرد.

۲. تست و اندازه‌گیری تجهیزات از نظر عایقی

۳. طی سه میدان های الکتریکی

۴. انواع عایق‌ها { گازی / مایع / جامد

تلفات برق ایران حدود ۲۰ درصد است، در بوشهر حدود ۵۰ درصد است که البته شامل برق دزدی هم می‌شود.

قدرت نصب شده در ایران ۵۰ هزار مگاوات است و قابل استفاده‌ی آن ۴۰ هزار مگاوات است.

هر ۴۰۰ تراکنش در کل می‌زنند که هر کیلومتر حدود ۱۶۰ میلیون روی آنهاست.

PAPCO

www.iran-ieee.com

Subject :

Year . Month . Date . ( )

ولتاژهای استاندارد

۱. ولتاژ معمولی با فرکانس قدرت (۵۰Hz یا ۶۰Hz)

۲. ولتاژ ضربه : ولتاژی است با دامنه ی بسیار بالا که در زمان کوتاه اعمال می شود.

۱. ولتاژ ناشی از رعد و برق ۲. ولتاژ ناشی از بازو بسته کردن کلید (که ممکن است تا ۲ برابر آید)

برای شبکه هایی که ولتاژ نامی آنها خیلی بالاست، ولتاژ ضربه ناشی از سوئیچینگ خطرناک است ولی در شبکه هایی که ولتاژ نامی آنها پایین تر است ولتاژ رعد و برق خطرناک تر است.

ولتاژهای سوئیچینگ چندین برابر ولتاژهای رعد و برق اند.

ولتاژ سوئیچینگ این خط ۴۰ kV

۲۰ kV → ۲۰۰ هزار ولت

ولتاژ رعد و برق

پس ولتاژ رعد و برق در شبکه هایی که تلفات ولتاژ نامی آنها پایین تر است، خطرناک تر است

ولتاژهای تست

۳. ولتاژ های DC :

AC

$\frac{V_P}{2}$ V_P $\frac{V_P}{2}$

مدار

$2 \times \sqrt{3}\, V_L\, I_L \frac{1}{\cos\varphi}$

$2\sqrt{3} \times \sqrt{3}\, V_{Pn}\, I_P$

مقدار موثر است

سازمع قدرتی که روی آن با این خط AC اشتغال دارد

DC

حداکثر اختلاف ولتاژ بین این دو نقطه

$\sqrt{2}\, V_{Pn} = \frac{V_{DC}}{2} = V_{max}$ (rms)

$3\, V_{DC} I_{DC}$

۳ تا فاز

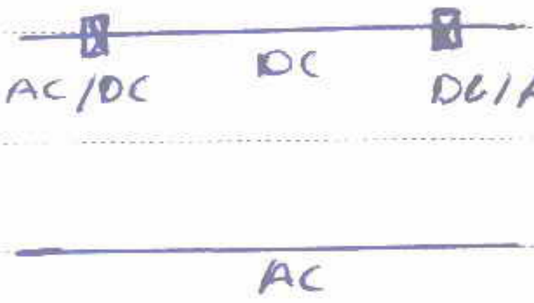
اگر خط های AC و DC با توجه به این که جریان آنها را می توان $I_{DC} = \frac{1}{AC} I_{AC}$ گرفت

www.iran-ieee.com

Subject: ۲

Year. Month. Date. ( )

$$\frac{P_{DC}}{P_{AC}} = \frac{۳\sqrt{۲}\,V_{Pn}\,I_{DC}}{۶\,V_{Pn}\,I_{AC}} = \sqrt{۲} = ۱,۴۴ \qquad P_{DC} = \sqrt{۲}\,P_{AC}$$



این AC/DC ها گران اند و وقتی خط انتقال DC بهره تر است

که خط طولانی باشد.

جاهایی که خط های DC استفاده می شوند:

۱- جاهایی که خط خیلی طولانی باشد.

۲- این که تلفات آن $۶\%H_2$ و نصب آن $۵۰\%H_2$ است.

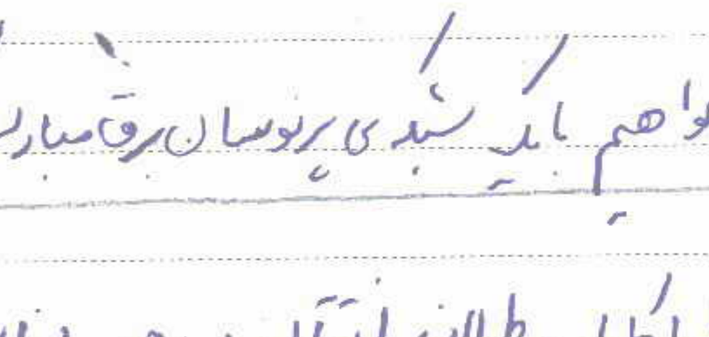
۳- جاهایی که می خواهیم باید شبکه برق متصل کنیم و این نوسان به شبکه ها ربط پیدا نکند (ترنتو و سیدنی)

۴- جاهایی که برق را با کابل و طولانی انتقال می دهیم. (فرانسه و انگلستان از طریق کابل داخل دریا همدیگر برق دارند)

چون در کابل ها خاصیت خازنی زیاد می شود و کابل های سوزد.

تولید ولتاژ DC: ولتاژی که تغییرات نمی داشته باشد و تقریباً ثابت باشد.

ولتاژ متوسط $\left(\bar{V} = \frac{۱}{T}\int_{۰}^{T} v(t)\,dt\right)$



دامنه ولتاژ ریپل $\left(\delta V = \frac{۱}{۲}(V_{max} - V_{min})\right)$

ripple factor $\left(\frac{\delta V}{V} \times ۱۰۰\right)$ ⟵ مثلاً در روش $۱۰۰\,kV$، $۱۰\,kV$ - $۹۰\,kV$

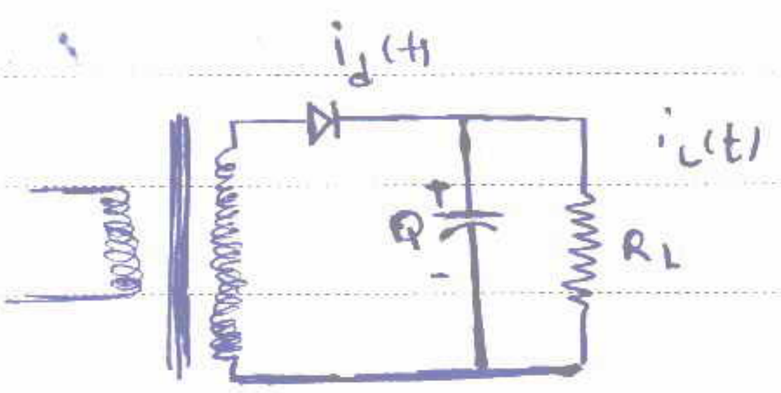
PAPCO

www.iran-ieee.com

Subject :
Year . Month . Date . ( )

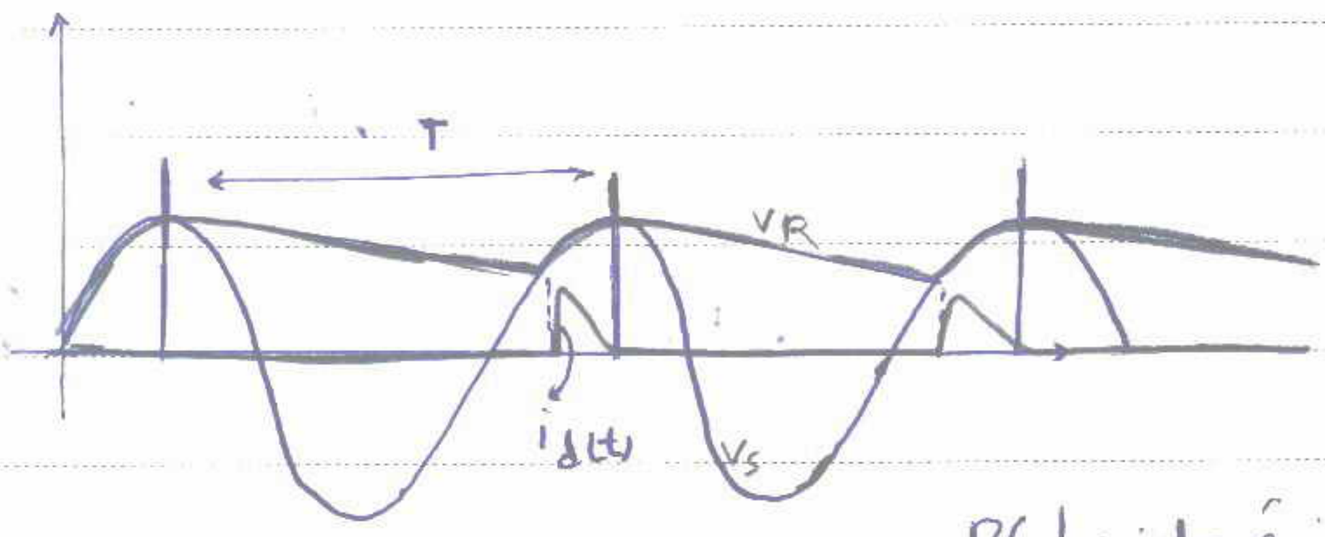
روش‌های تولید ولتاژ DC :

۱- یکسوسازی نیم موج :



$i_d(t)$ فقط خیلی نیشتر از $i_L(t)$ است باید از یکسوسازی

استفاده کرد که تقریباً این جریان را داشته باشد.



اگر بخواهیم ripple را کم کنیم خازن را

بزرگ و تقریباً گرم چون خازن را خان

50^{HZ} و تقریباً گرمند و ظرفیت این خازن تعیین کننده قیمت این مولد DC

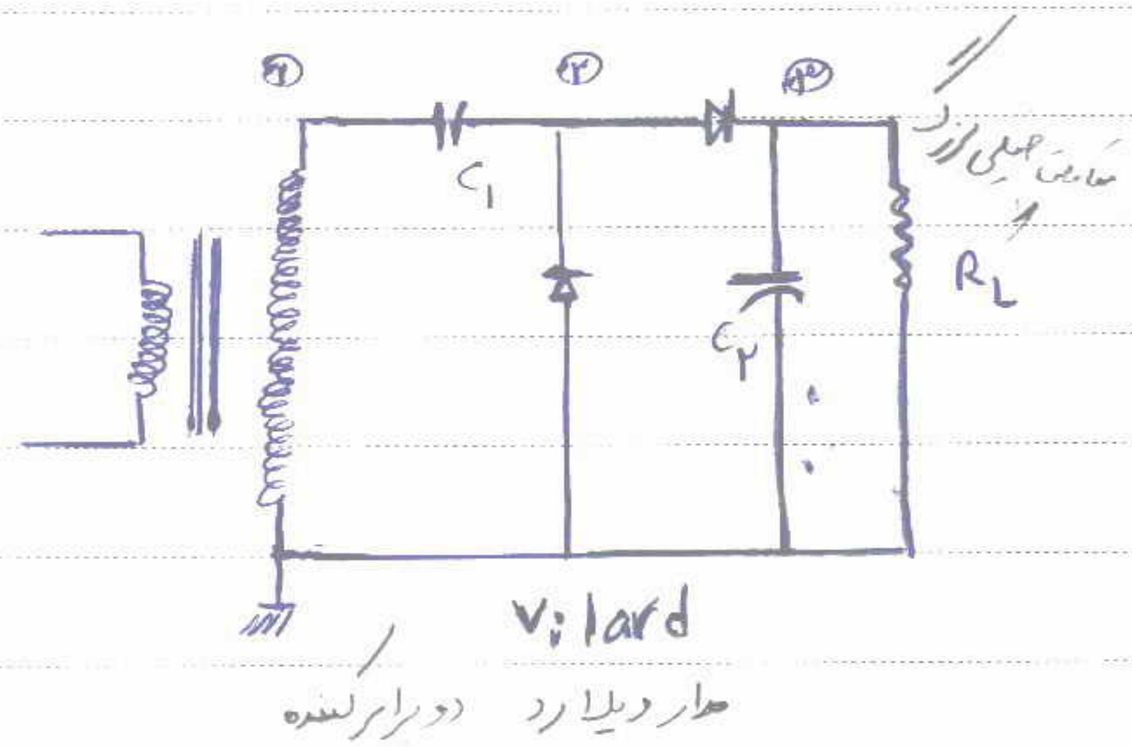
خواهد بود.

$$\delta V = \frac{IT}{2C} = \frac{I}{2fC}$$

$$Q = 2\delta V C = IT$$

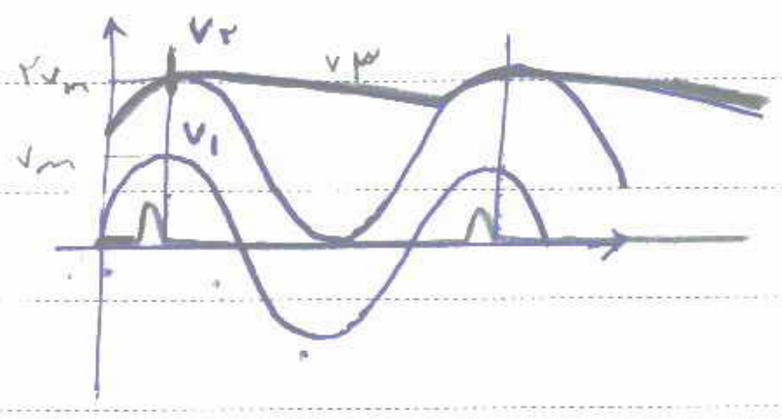
تغییر بار در زمان

$$i = C\,dv/dt$$



مقاومت معادل کل بار

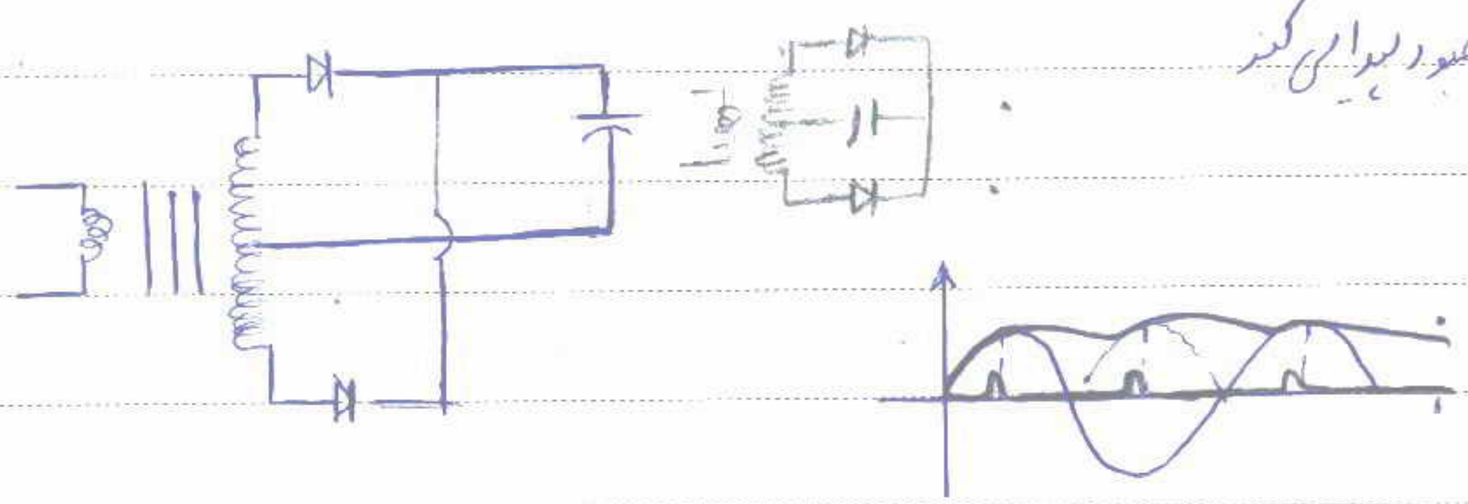
مدار دیاردر دو برابر کننده

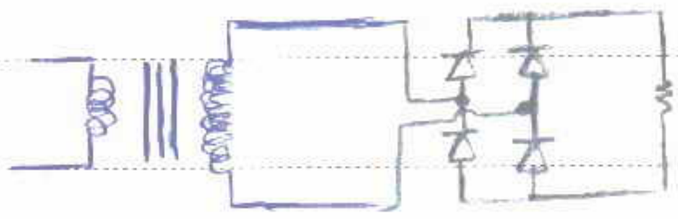


www.iran-ieee.com

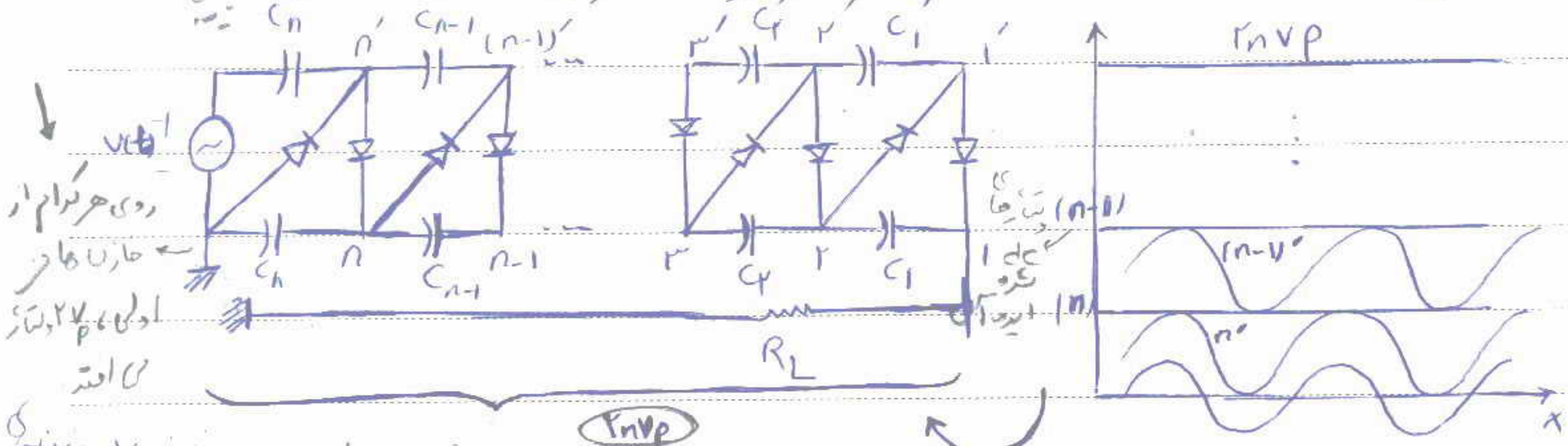
Subject: ۳

Year. Month. Date. ( )





۲- مدارهای ولتاژ چندطبقه:



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \longrightarrow \delta V = \frac{I}{2f}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{C_i}$$

$$\delta V = \frac{I}{2f}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{2}{C_2} + \cdots + \frac{n}{C_n}\right)$$

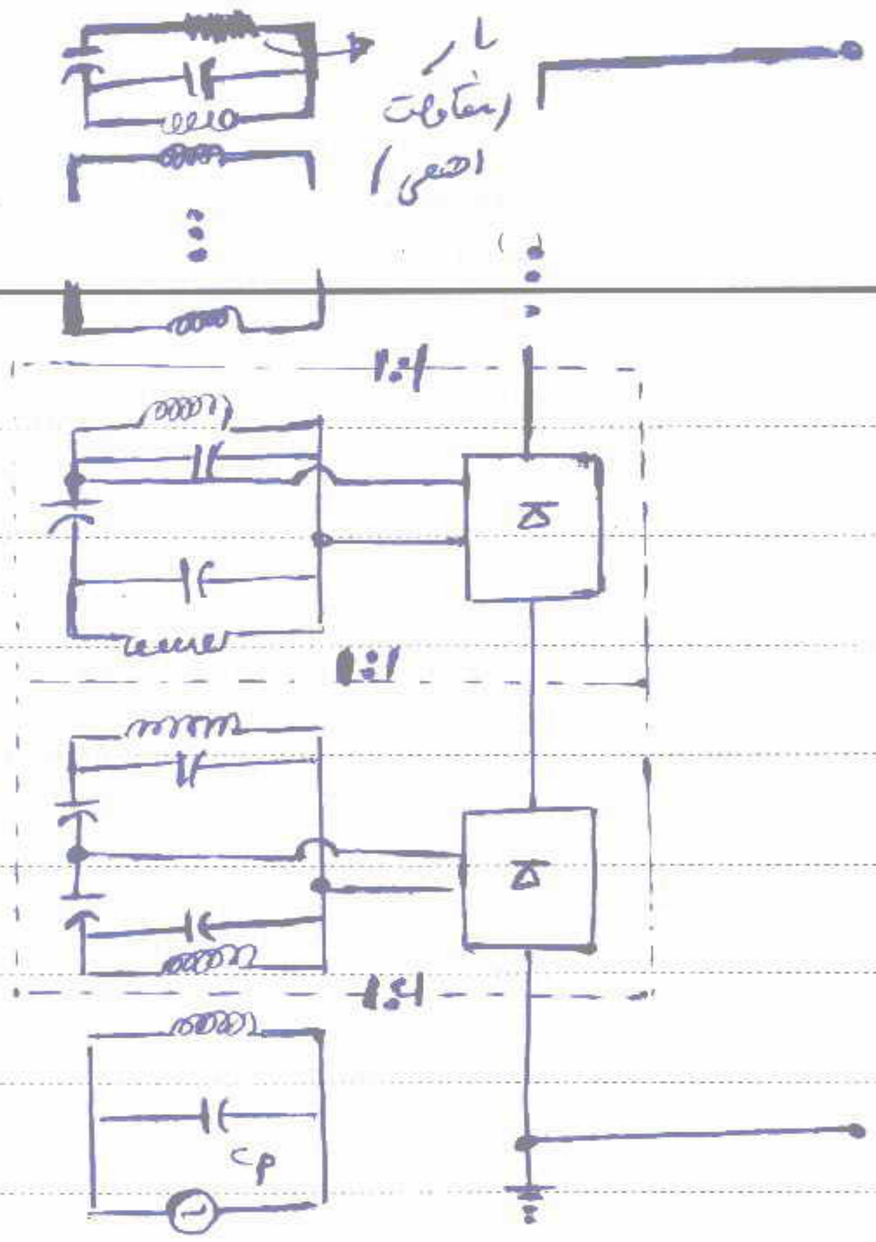
$$C_1 = C_2 = \cdots = C$$

$$\delta V = \frac{I}{fC} \times \frac{n(n+1)}{4}$$

www.iran-ieee.com

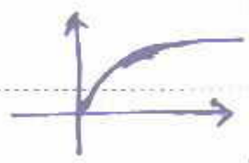
Subject :

Year .



- خازن های سری ، اتوکنترل را خنثی می کنند.

- وقتی اولیه ی ترانس بار می بیند مشکل ایجاد



می شود

هسته اشباع می شود برای حل این مشکل هسته از

جنس ویژه ای (که ثابت آن ها با بالا رفتن هر طبقه افزایش می یابد)

هوا استفاده کرده اما بدون هسته بار مغناطیس کنندگی

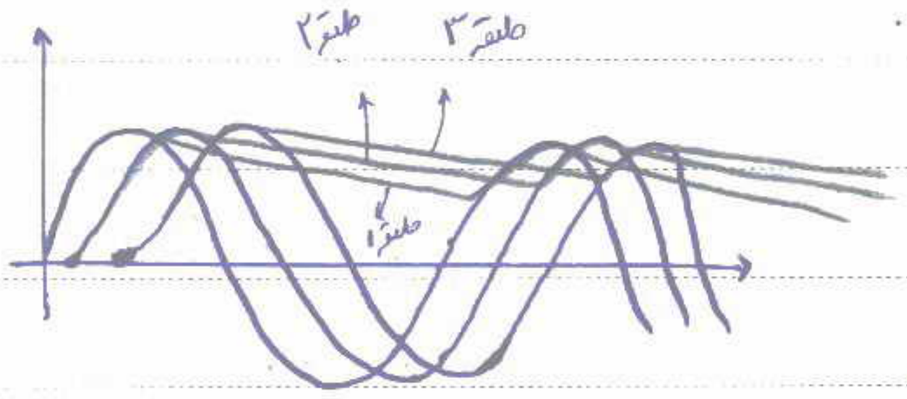
- نیاز است برای تأمین آن از خازن استفاده کردند.

- در این مولد تأمین هر طبقه با دیود طبقه بعد است

- اگر با اینتهای خط کم باشد و تأخیر بالای رو رول اگر بار اینتهای خط زیاد باشد و تأخیر پایین می آید.

- اگر بار $\sqrt{3}=z$ باشد افزایش ی دیگر در تمام طول خط نخواهد بود و مقاومتی زاویه تغییری کند

- این مولد در حقیقت مدت خط انتقال است که ولتاژ آن را $2c$ افتاب



کرد. اندازه تأخیر زمانی آن یکی باشد و فقط زاویه دیگر

تغییر کند و این تأخیر شکل موج دیگر طبقه روی هم این قضیه

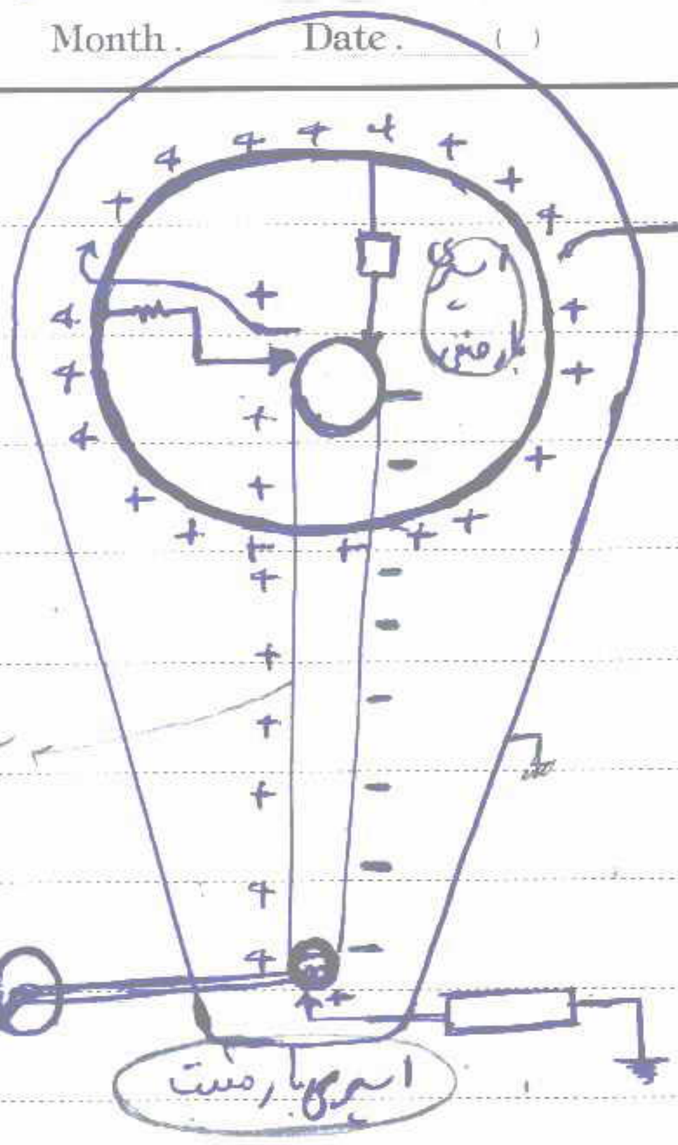
است که دقتی این ۳ شکل موج در خروجی جمع می شود ripple کاهش می یابد.

PqPCO

www.iran-ieee.com

Subject: ۴

Year. Month. Date. ( )



۱- مولد وان دوگراف مز

یا مولد دتاژ الکترواستاتیک

این مولدها دتاژ را می تواند تا چندین میلیون ولت بالا برد

$(\frac{C}{m^2})$ با سرعت تسمه

(m) با پهنای تسمه

$(\frac{C}{m^2 s})$ که بار را روی تسمه قرار می دهد

$I = \sigma b v$ مقدار بار برخاسته

بالاترین جریانی که می توان با این مولد ساخت:

$\sigma = 2\nu\ \mu C/m^2$ $\quad v = 20\ m/s$ $\quad b = 1\ m$

علت این دتاژ خطرناک نیست چون بار کمی روی آن جمع می شود.

$I = 40\ \mu A \simeq 0.04\ mA$

جریان بالا $\rightarrow$ $20 - 1\ mA$

پس جریان کمی خواهد داشت. این مولد دتاژ اش زیاد تنظیم شده نیست.

△ ابزارهای دتاژ ... برای تغذیه ... جریان ... → ... DC

تولید دتاژ AC: امکان ساخت دتاژ سینوسی کامل وجود ندارد یعنی حتی دتاژ ژنراتورها هم تقریباً سینوسی است.

دتاژ مؤثر $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$ (موج)

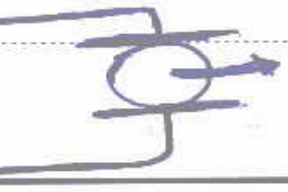
دتاژ اگر نسبت $\frac{V_p}{V_{rms}} \simeq \sqrt{2}$ باشد و سینوسی رفتار کرد.

$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt}$

$\frac{V_p}{V_{rms}} \simeq \sqrt{2} \rightarrow \frac{V_p}{V_{rms}} = \sqrt{2} \pm 5\%\sqrt{2}$ به عنوان سینوسی کامل قبول است

در تست تجهیزات حساس دار برای اندازه گیری از ولتاژ متر با امپدانس بالا از ولتاژ متر استفاده می کنیم به خصوص در کانس بالا

منبع دتاژ تست ← جریان راهم باید علاوه بر دتاژ تأمین کند



تجهیز اعلق مورد تست

جریان و دتاژی $\rightarrow$ $\begin{cases} I = J\omega C V_t \\ P = J\omega C V_t^2 \end{cases}$ J عدد موهومی

که منبع دتاژ تست باید تأمین کند.

PAPCO
www.iran-ieee.com

Subject:

Year. Month. Date. ( )

— اگر این جریان تامین نشود ترانس خواهد سوخت، کفاشیکها جریان بیشتر را می‌کشند و ولتاژ خروجی افت زیادی خواهد داشت

$P_n = K \omega C V_t^2$

ظرفیت خازنی تجهیزی که باید تست شود

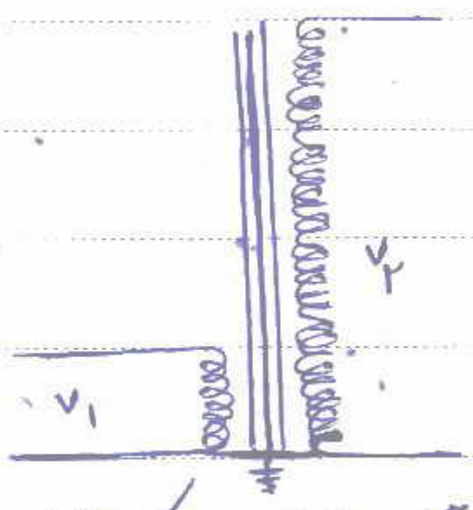
ترانسفورماتور تست:

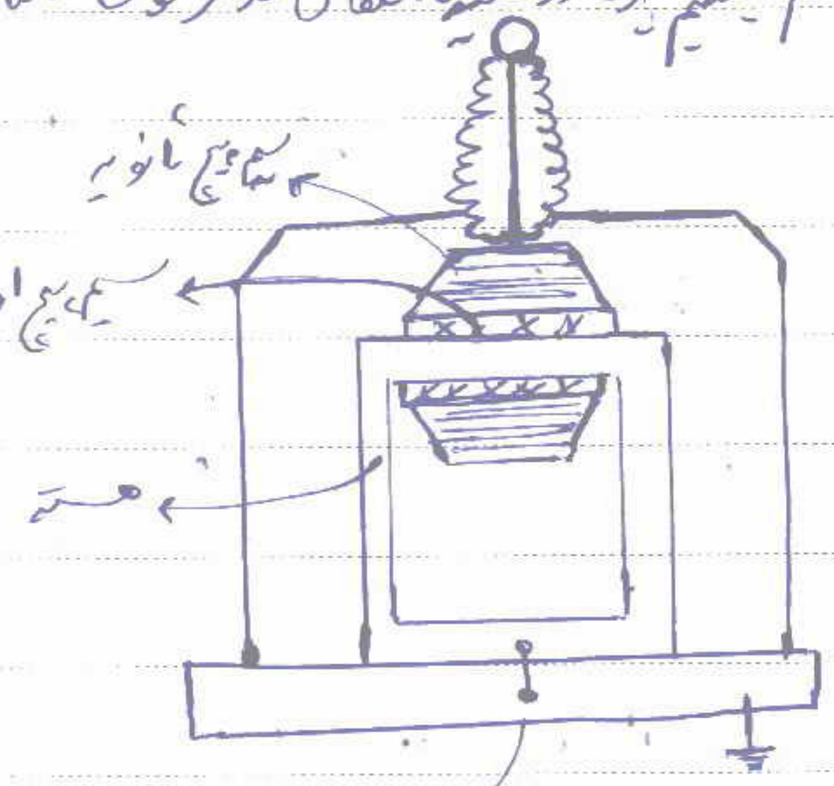
در ترانس های معمولی هدف انتقال قدرت است و

کاهش تلفات برای ما مهم است ولی در این ترانس ها اینکه سیم پیچ

چگالی ما مهم است

به اشباع نرود. (ماهیتک الکترونیک دستگاهات) در این ترانس ها مهم نیست چون در تقسیم انتقال حداکثر توان ۵۰٪ تلفات





خواهیم داشت $Z_{eq} = Z_{in}$

$C = \varepsilon A / d$

$cte = 2\pi r l$

سیم پیچ ثانویه را به گونه‌ای سیم پیچی می‌کنیم چون می‌خواهیم ظرفیت خازنی حداقل باشد

ثانویه باید لایه بندی ثابت باشد که در صورت ثابت بودن خازن را می‌تواند

میدان یکنواخت باشد و با این کار عایق کاری کاهش می‌یابد در صورتی که

اگر میدان یکنواخت نباشد باید عایق کاری رشته برای بیشترین میدان طراحی شده باشد.

مقایسه ۱: این ترانس از آنجا که ترانس فلزی است برای مدتی با بیرون انتقال گرما دارد ولی در ترانس بعدی چون بدنه از جنس عایق است مبادله گرمایی اش کم است.
(تعداد کار بیشتر)

مقایسه ۲: این ترانس ارتفاع اش زیاد خواهد شد ولی ترانس بعدی ارتفاع زیادی نخواهد داشت

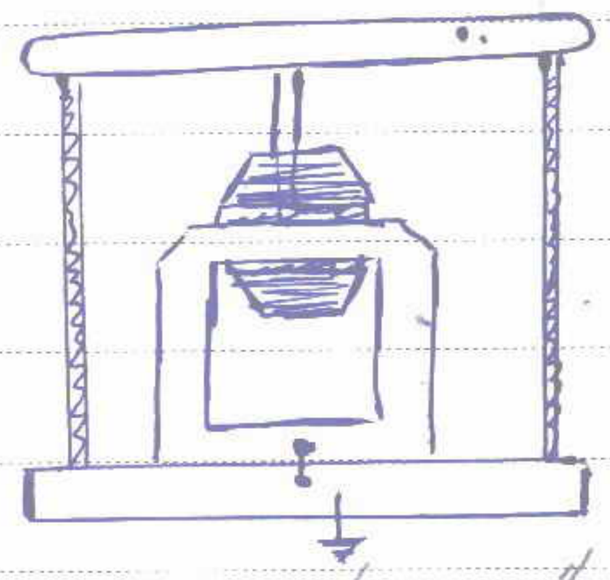
مقایسه ۳: در این ترانس برای سوی کردن شدن باید هر ترانس را روی پله ای بالاتر گذاشت که آن پله از جنس عایق خواهد بود

Papco
www.iran-ieee.com

Subject: ۵

Year. Month. Date. ( )

دلی ترانس بدی را برای سری کردن روی هم دیگری توان قرار دارد.



ترانسفورماتورهای کاسکاد یا چندطبقه:

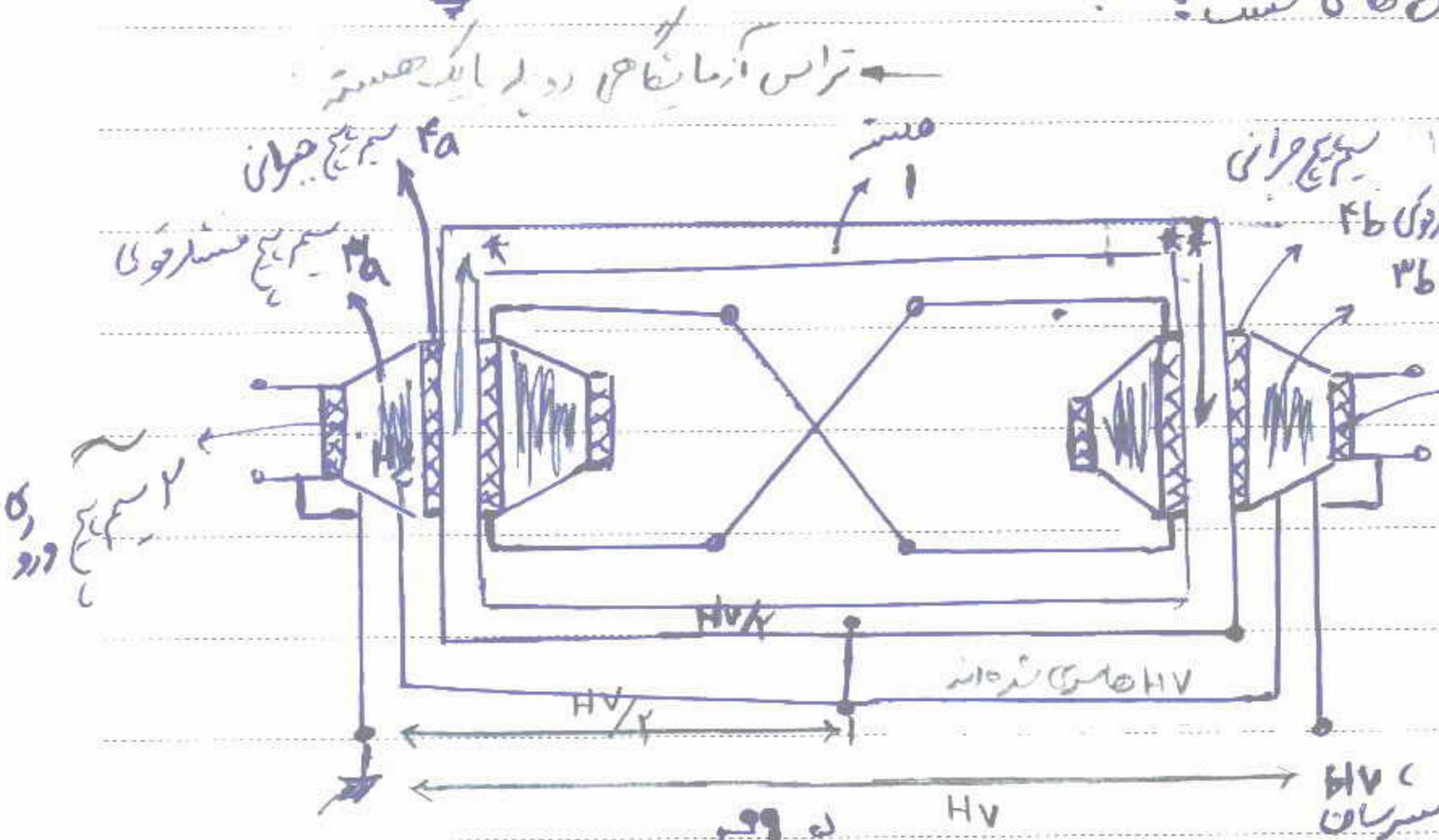
- یکی از روش های سری کردن ترانس های تست:

- تحمل هسته $\frac{HV}{2}$ است.

- هر وقتی که ۲ دارد ۵ هم دارد با

این تفاوت که فرض ها متفاوت

است (HV و زمین)

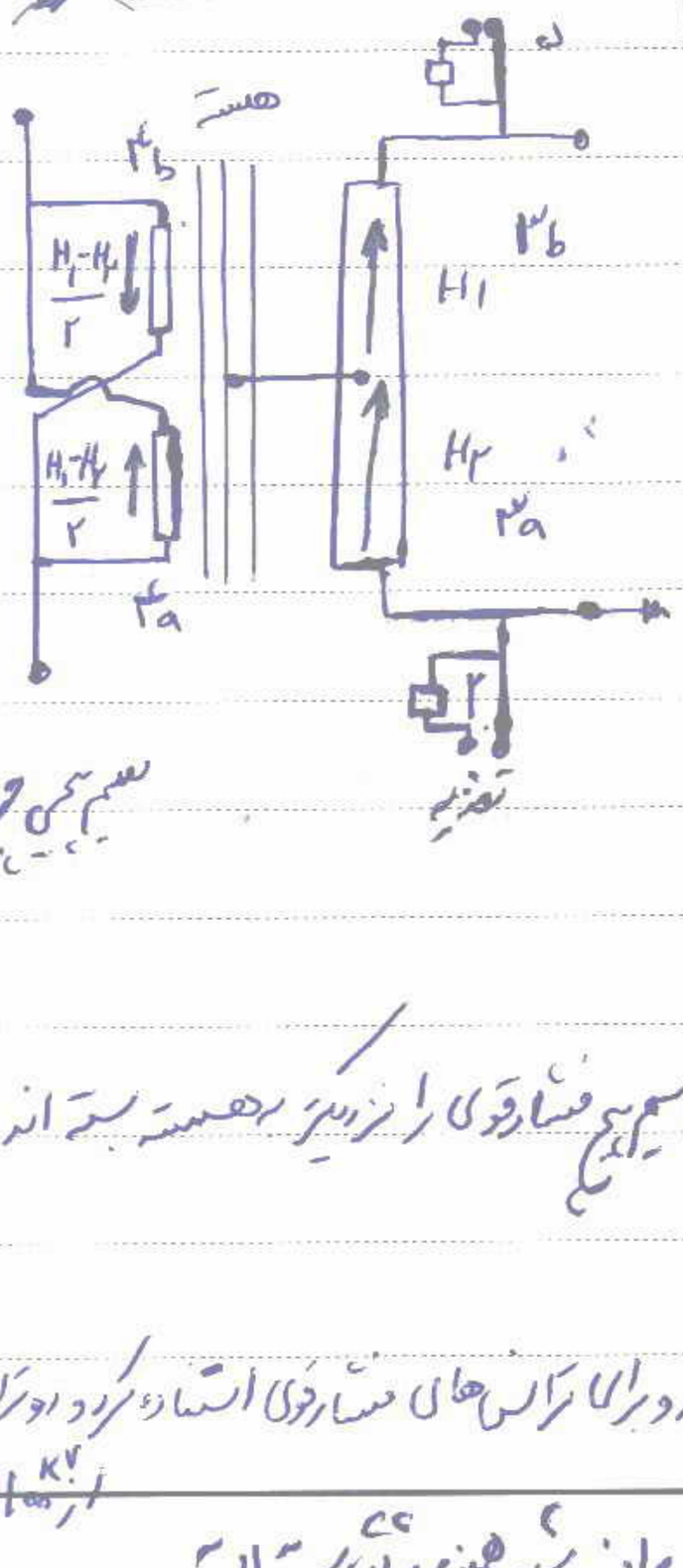


- شارهای * و ** و *** باید برابر باشند تا شار فعال مسیرشان HV

در هسته بسته نشود و موجب داغ شدن و اضافه جریان خواهد شد

که با سیم پیچ نمی توان این شارها را برابر کرد بلکه از سیم پیچ جبرانی برای ایجاد شار مقابل استفاده می کنند بطوری که

$$H_1 - \frac{H_1 - H_2}{2} = \frac{H_1 - H_2}{2} + H_2 = \frac{H_1 + H_2}{2}$$



- سیم پیچ فشار قوی را روی شکل ساخته اند بنابراین صرف جدی در خاصیت عایقی و ولتاژی را هسته هم یکنواخت کرده اند.

و با این کار امکان ندارد

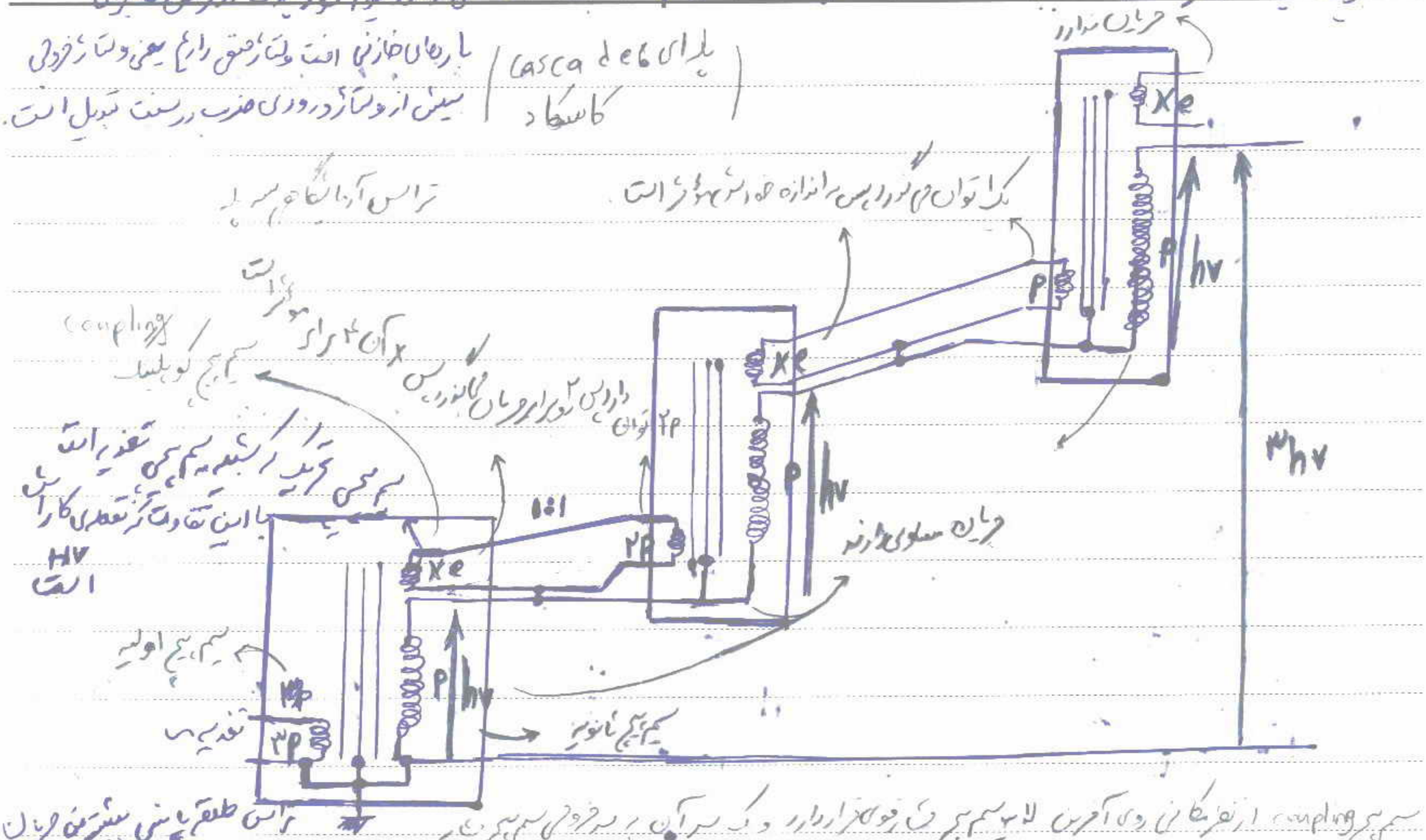
- سیم پیچ فشار ضعیف را معمولاً روی هسته می پیچند چون عایق بندی کمتر نیاز دارد ولی در اینجا سیم پیچ فشار قوی را نزدیک به هسته بسته اند اما ولتاژ این را با هسته هم یکنواخت کرده اند.

- می توان رو یا پهنه رشته از این ترانس ها را بصورت کاسکاد به هم وصل نمود و برای ترانس های فشار قوی استفاده کرد و ترانس خیلی برای کمتر از ۱۰۰ KV اقتصادی نمی باشد.

- وقتی سیم پیچ شفاف پیدا شده است یک شکل بسته ای ندارند و سیم پیچ جبرانی شبیه همین شکل بسته است.

PARCO
www.iran-ieee.com

-جریان این ترانس ها کم است و بار آنها معمولاً خازنی می باشد چون این ترانس های آزمایش عایق دستگاه ها کاربرد دارند که این عایق ها مشکل خازنی می دهند : که برای جبران این بار خازنی در هر پله یک راکتور قرار می دهند، هرچه با این راکتور می توان ضلع های بالای جریان نیز تنظیم کرد. -بهترین جبران سازی فنقریبی بیشتر از مقدار بار خازنی هم باشد تا مجموعه بار سلفی (اندوکتیو) شود چون ترانس ها برای بارهای خازنی امنیت ولتاژ حق را دارم یعنی ولتاژ خروجی بیش از ولتاژ ورودی ضریب در سمت ثانویه است.



- سیم پیچ coupling از نظر مکانیکی روی آخرین لایه سیم پیچ ثانویه قرار دارد و یک سر آن به سر خروجی سیم پیچ ثانویه وصل است - هسته و بدنه هر پله از لحاظ سیم پیچی فشار قوی هر چه پایین است

- همچنین یک سر سیم پیچ اولیه بوبین و هسته ی همان پله وصل است - پله های دوم و سوم و ... (دارای بارهای عایقی قرار دارند -

n تعداد طبقات

$$X_{res} = \sum_{v=1}^{n} \left[X_{hv} + (n-v)^2 X_{ev} + (n+1-v)^2 X_{pv} \right]$$

فشار قوی — کوپلینگ — اولیه

$1^2+1^2+1^2$ 1^2+2^2 $1^2+2^2+3^2$

برای ۳ طبقه $X_{res} = 3X_h + 5X_e + 14X_p$

برای حل این شکل باید طبقات پایین تر X_{res} آن کوچک باشد تا جریان بیشتر طبقات پایین تر شکل سازنباشد ولی اشکال این ایده این است که خرید چند نوع اتصالی نیست

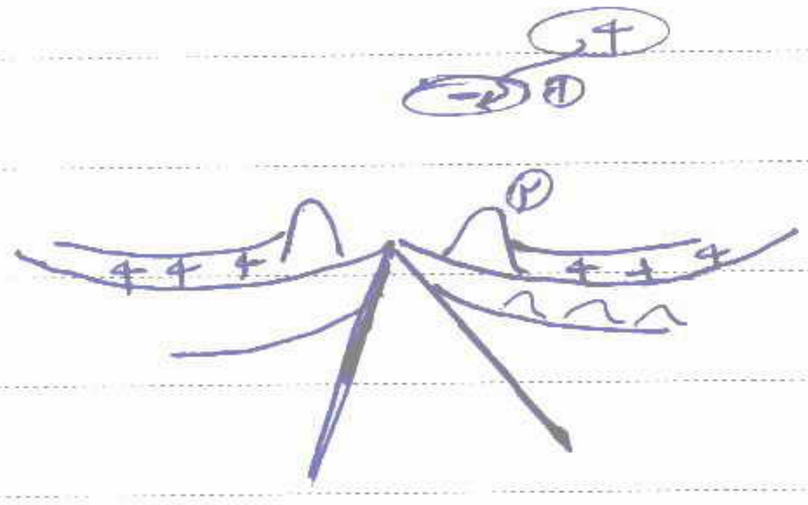
www.iran-ieee.com

Subject: ۶
Year. Month. Date. ( )

تولید ولتاژ ضربه:

۱. ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ (کلیدزنی) کوتاه مدت شبکه قدرت

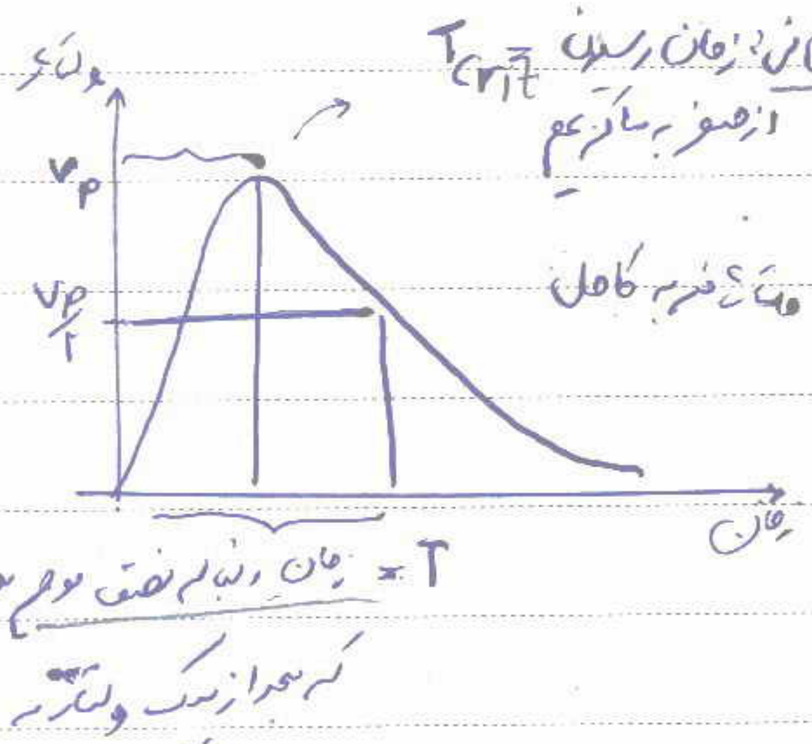
۲. ولتاژ ناشی از رعد و برق



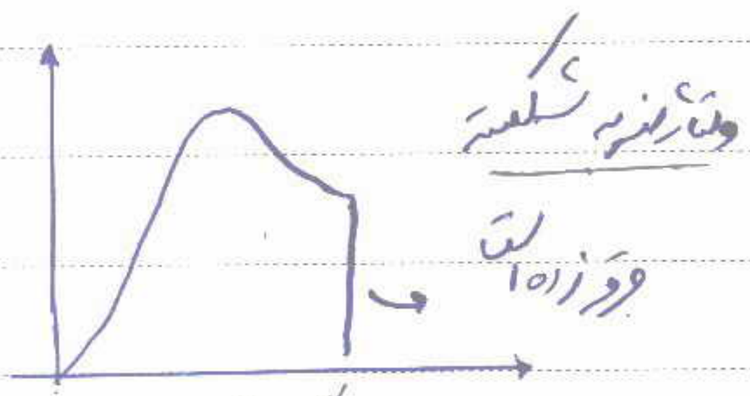
هیچ ولتاژ ضربه شکست هم نیست و استاندارد آن به صورت زیر است:

- برای تست عایقی در مقابل موج رعد و برق $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{250}$ $\frac{1}{2500}$ μs

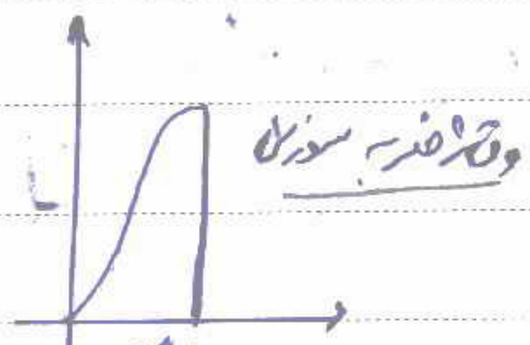
- برای تست کلیدزنی $\begin{cases} T_{cr} = 250\ \mu s \\ T_2 = 2500\ \mu s \end{cases}$



ولتاژ
V_p
$\frac{V_p}{2}$
زمان
T_{cr2} = زمان رسیدن از صفر به ماکزیمم
زمان نیم مقدار کامل
T = زمان رسیدن نصف موج پس از زمان
که بعد از شکست ولتاژ $\frac{V_p}{2}$ می‌رسد



ولتاژ ضربه شکست
ورود از اول است
زمان‌ها نصف موج‌اند



ولتاژ ضربه سوزنی
زمان‌ها قبل یا در ماکزیمم است

ولتاژ ضربه شکست: $\begin{cases} V_p \\ T_{cr2} \end{cases}$
T زمان از ابتدا تا زمان شکست

ولتاژ ضربه کامل: $\begin{cases} V_p \\ T_2 \end{cases}$
T_2 نصف طول دم

ولتاژ ضربه سوزنی: $\begin{cases} V_p \\ T \text{ زمان تا شکست} \end{cases}$

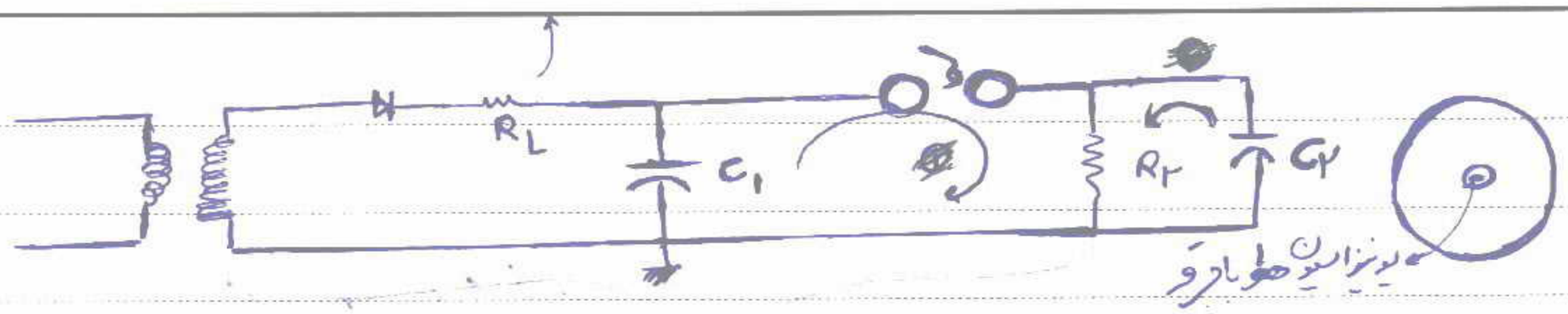
اگر در تست کامل را ولتاژ ضربه سوزنی را جواب می‌دهد.

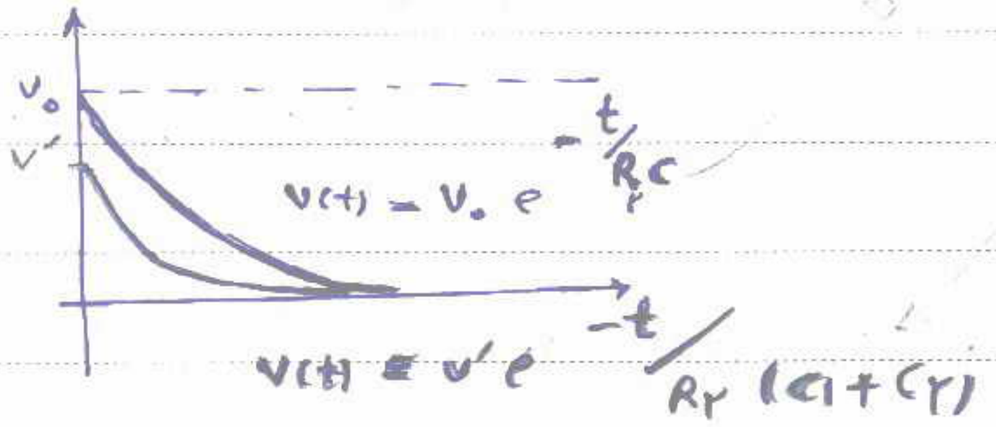
P4PCO

www.iran-ieee.com

Subject: مقاومت بار در مدار یکسو کننده تمام موج نقش محدود کردن جریان را دارد

Year. Month. Date. ( )





(مابقی پس از ضربه‌ای کندن جریان ولتاژ آن به $\frac{di}{dt}$ تا $V=0$ بستگی دارد که یعنی ولتاژ به سرعت و تغییرات جریان بستگی دارد که برای ما کنترل پذیر نیست)

$$Q = C_1 V_0 = (C_1 + C_2) V' \longrightarrow V' = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_0$$

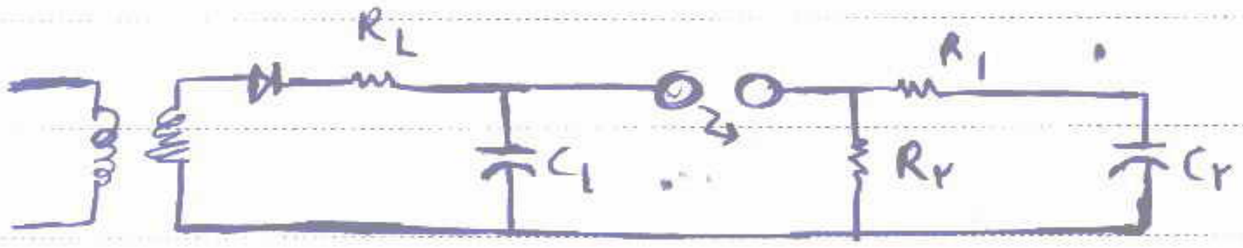
بایستگی بار

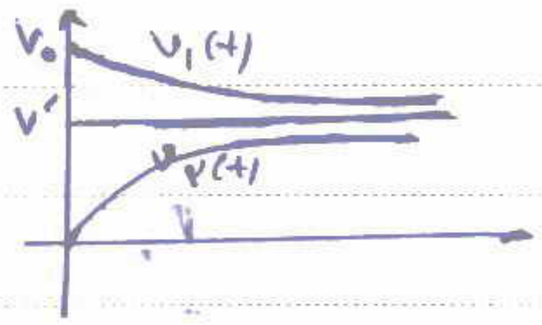
بار کل مقدار ثابتی است

مقدار انرژی ذخیره شده صرف حرارت و یونیزاسیون می‌شود

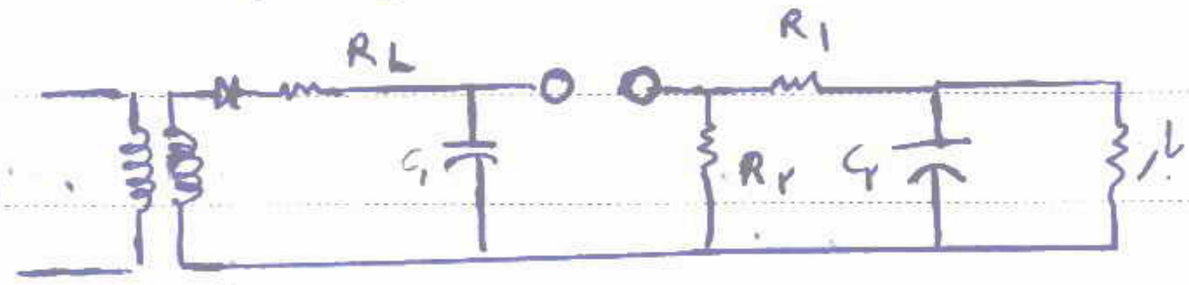
$\frac{1}{2} C_1 V_0^2 > \frac{1}{2}(C_1 + C_2) V'^2$

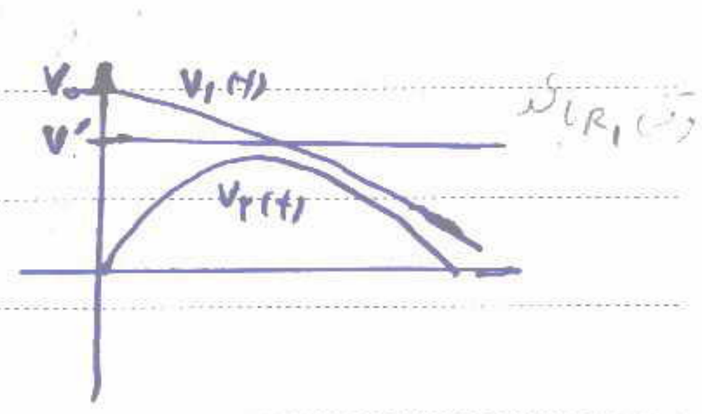
انرژی





وقتی R_1 بزرگ





وقتی R_1 کوچک

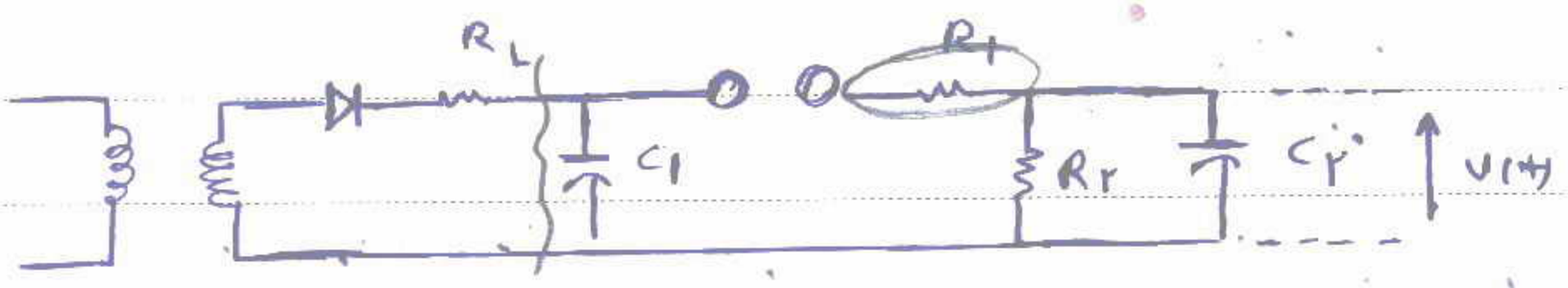
PaPCO

www.iran-ieee.com

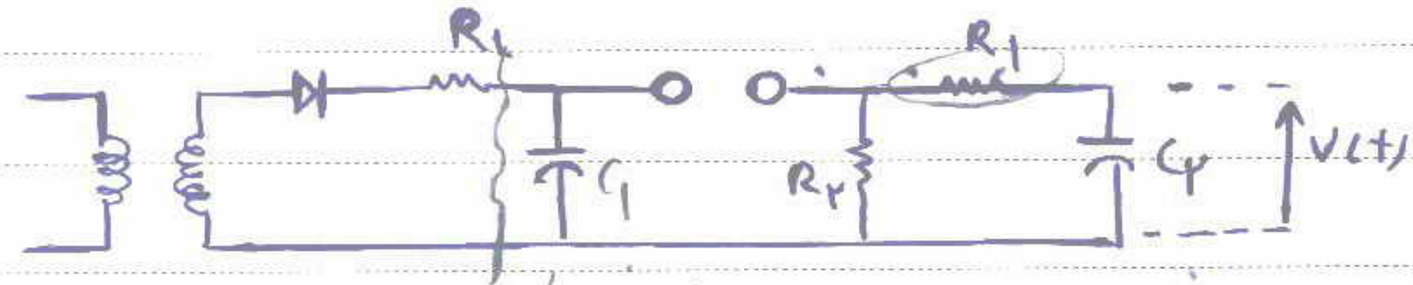
Subject: V

Year. Month. Date. ( )

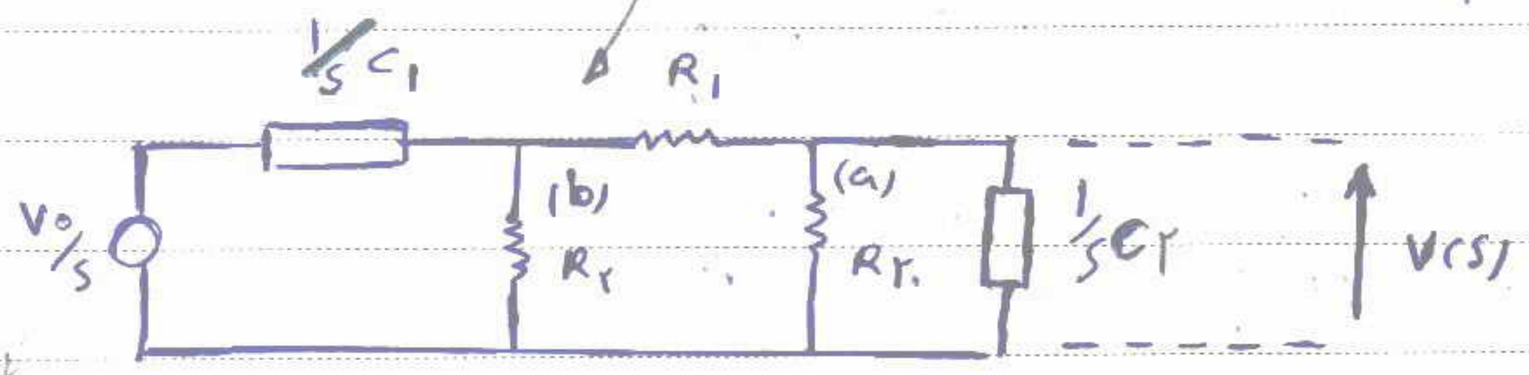
(a)



(b)



لاپلاس



$$V(s) = \frac{V_0}{s} \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad , \quad Z_1 = \frac{1}{C_1 s} + R_1 \qquad Z_2 = \frac{R_2 / C_2 s}{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}$$

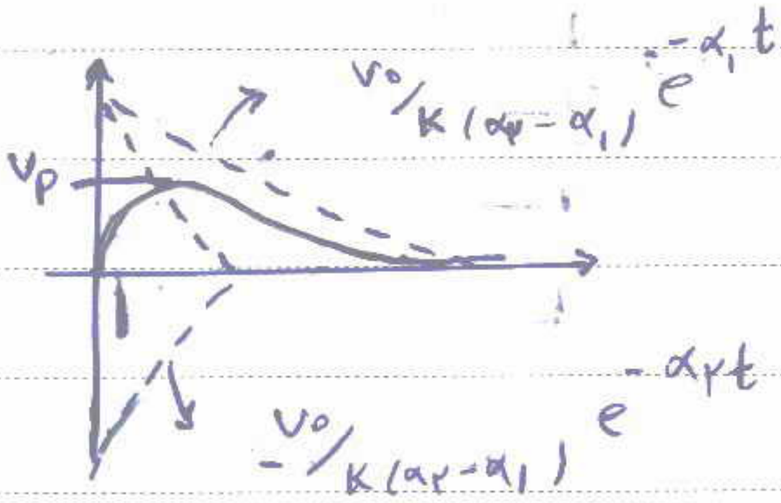
$$V(s) = \frac{V_0}{K} \frac{1}{s^2 + As + B}$$

a) $$A = \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}$$

b) $$A = \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_1}$$

$$B = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \qquad K = R_1 C_2 \qquad \text{// , //}$$

$$v(t) = \frac{V_0}{K} \frac{1}{\alpha_2 - \alpha_1} \left(e^{-\alpha_1 t} - e^{-\alpha_2 t} \right) \qquad s^2 + As + B = 0 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 = \frac{A}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 - B}$$



$\eta = \frac{V_p}{V_0}$ (راندمان)

$\frac{dv(t)}{dt} = 0$

P4PCO

www.iran-ieee.com

Subject :

Year . Month . Date . ( )

$t_{max} = t_{cr} =$ مقدار مورد نظر طراحی

$$\rightarrow \quad t_{max} = \frac{\ln(\alpha_2/\alpha_1)}{(\alpha_2 - \alpha_1)}$$

$$\eta = \frac{(\alpha_2/\alpha_1)^{-[\alpha_1/(\alpha_2-\alpha_1)]} - (\alpha_2/\alpha_1)^{-[\alpha_2/(\alpha_2-\alpha_1)]}}{K(\alpha_2-\alpha_1)}$$

A) $\eta_A \approx \frac{C_1}{C_1+C_2} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{1}{1+\frac{C_2}{C_1}} \times \frac{1}{1+\frac{R_1}{R_2}}$

B) $\eta_B \approx \frac{C_1}{C_1+C_2} = \frac{1}{1+\frac{C_2}{C_1}}$ $\quad \eta_B > \eta_A$

هر خازن شارژ می‌شود تا ولتاژ کم

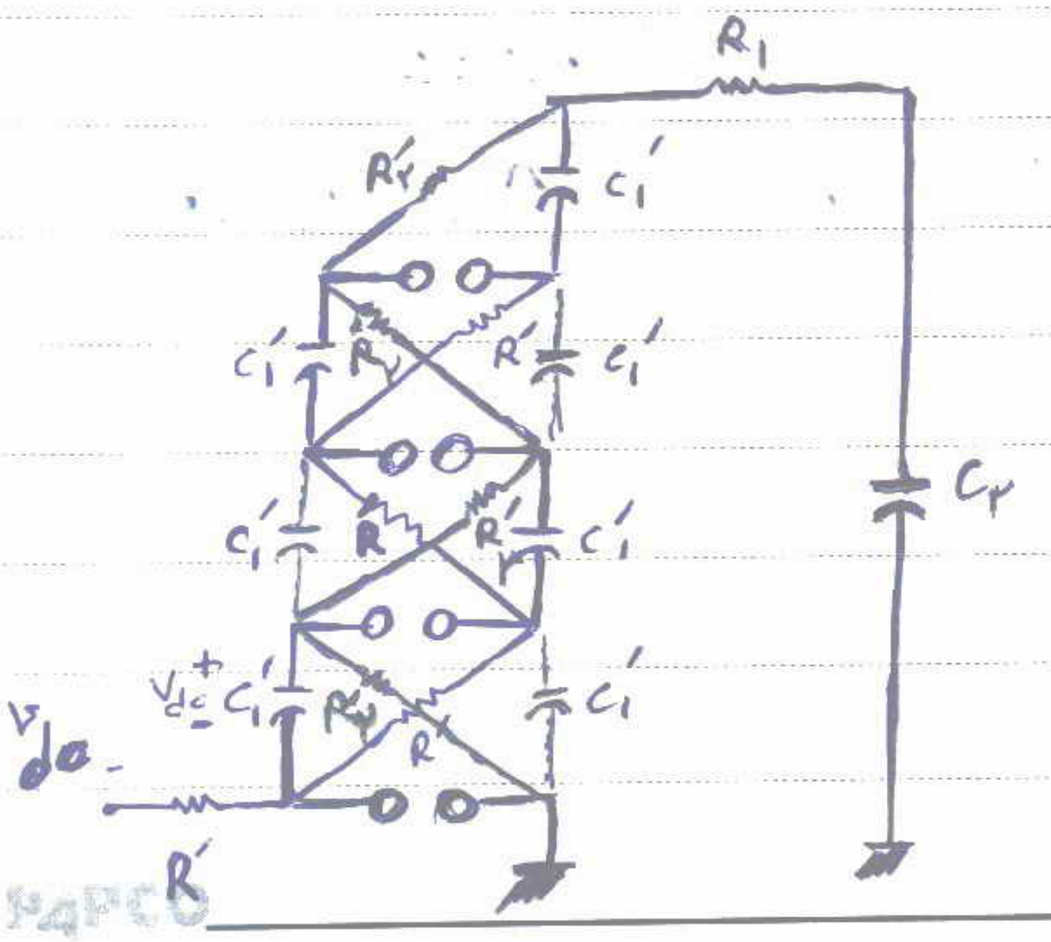
$-V_{dc}$

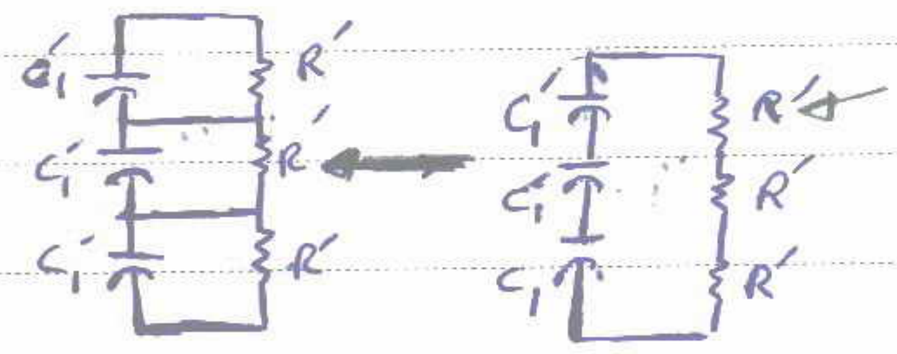
حرکت بین پایین‌ترین گره‌ها باعث حرکت گره‌های دیگر هم می‌شود

در حالت عادی خازن‌ها با هم موازی‌اند و بعد از حرکت هم باهم سری می‌شوند.

$\frac{1}{T} C_i/n$ $\quad nR'$

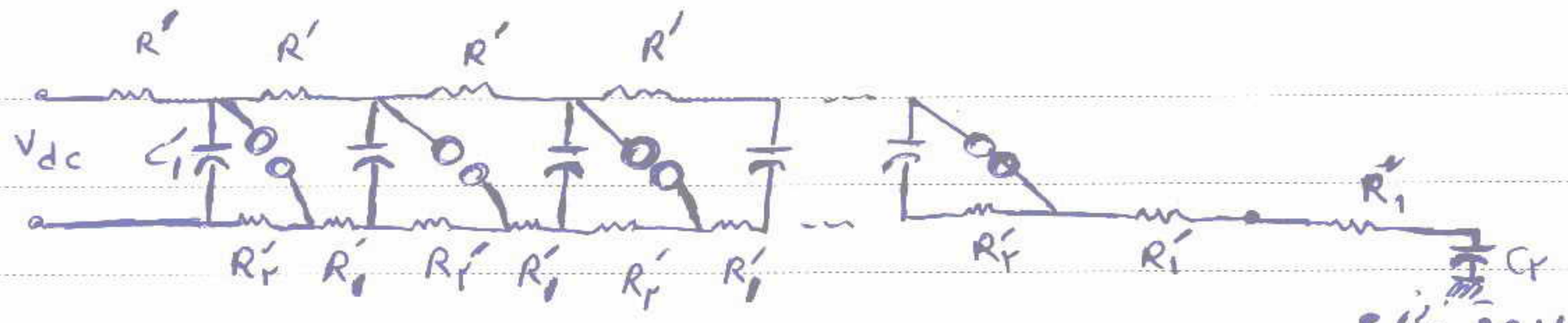
مولد پالس مارکس
MARX Generator





در طبقه آخر باید ولتاژ nV_{dc} خواهد شد.

www.iran-ieee.com



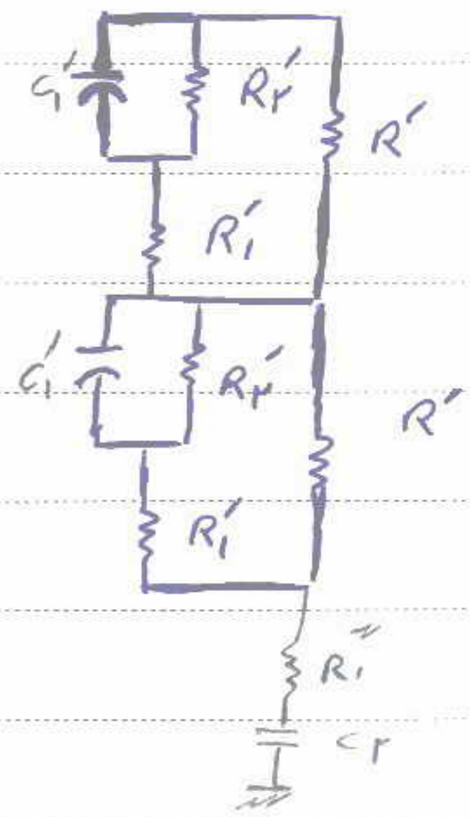
بعد از جمع زدن ۶

ضمن اینکه مقاومت‌های R_2' با هم موازی می‌شوند

جمع با R_1' سری می‌شود و کل این مجموعه با R' موازی می‌شود

$$\frac{1}{C_1} = \sum \frac{1}{C_1'}$$

$$R_1 = R_1'' + \sum R_1' \qquad R_2 = \| R_2'$$



www.
iran-ieee
.com

Subject :

Year . Month . Date . ( )

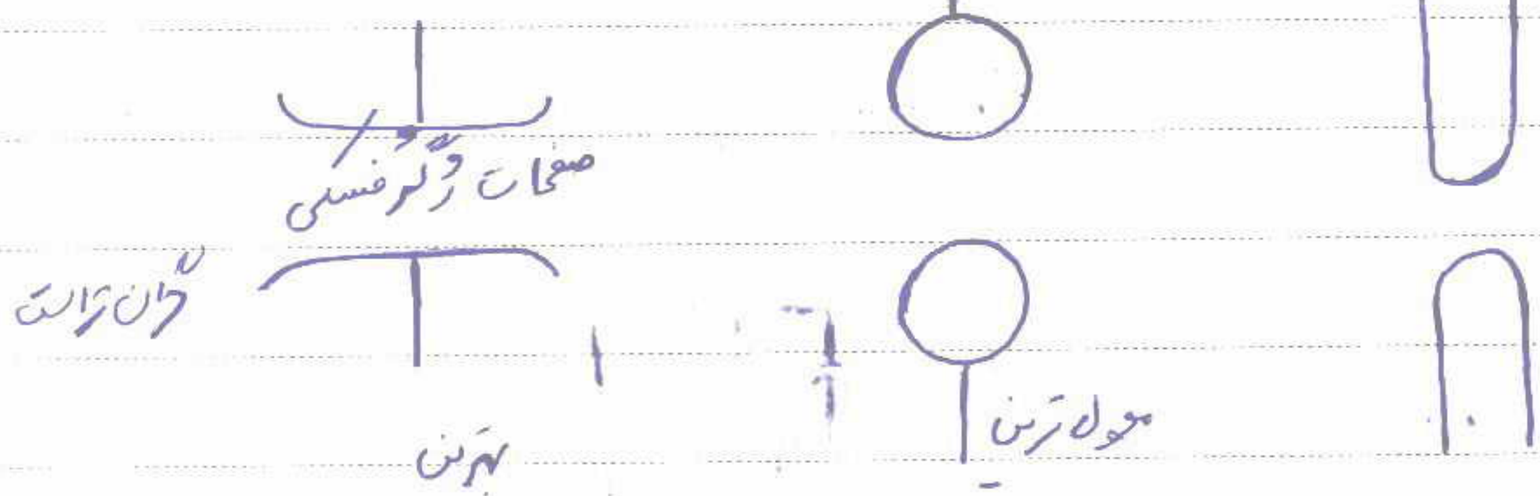
اندازه گیری ولتاژ متناوب چیست ؟

فاصله هوایی برای اندازه گیری یک ولتاژ یکبار می رود

- فاصله هوایی : یکی از بهترین روش ها برای اندازه گیری ولتاژها

برانواع ولتاژها

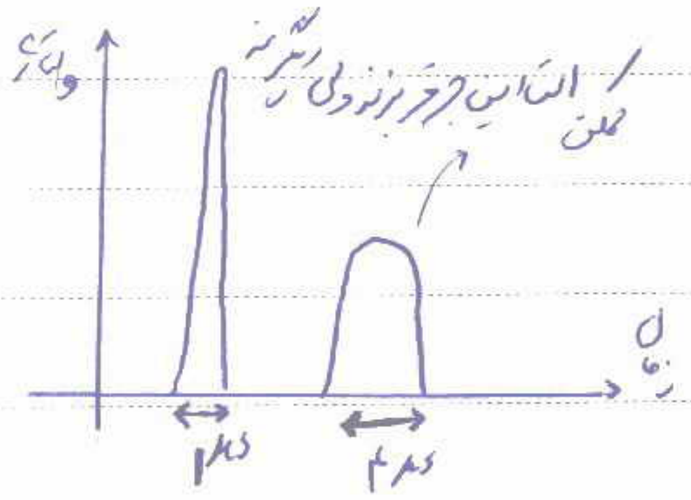
استفاده عایق با شدت میدانی که می تواند کمتر شبیه الکترونیکی شدت ولتاژ



چون معلوم نیست در یک فاصله چه ولتاژ اتوماتیک دوباره جرقه بزند ، فاصله هوایی را کمی بیشتر از حد مورد جرقه زنی در نظر می گیریم

سطح کره ها و یا صفحه ها باید کاملاً تمیز باشد ، در یک میلیمتر فاصله ای دورتر ممکن است ناهمواری میدان اثر بگذارد

فاصله ی هوایی برای اندازه گیری یک ولتاژ یکبار می رود

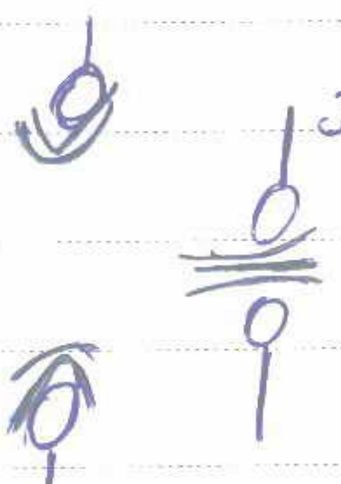


فاصله هوایی
زمان لازم برای شکست الکتریکی 1-3 میکرو ثانیه است .

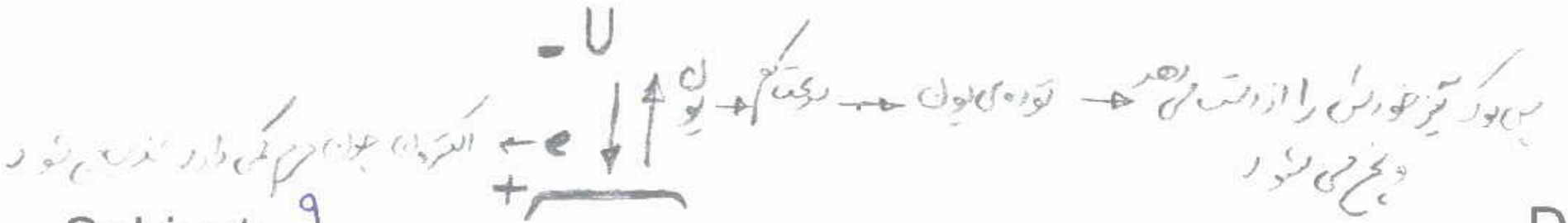
وقتی می خواهیم اندازه گیری ولتاژ انجام دهیم هر چقدر که شدت میدان یکنواخت تر باشد بهتر است . به همین دلیل کره های با قطرهای مختلف

وجود دارد که هر کدام برای فاصله های مختلف و ولتاژهای مختلف اند. آن اند.

(معمولاً در آزمایشگاه تا یک فاصله ای بصورتی دقیق است و دقت اندازه گیری دارد)



PAPCO
www.iran-ieee.com



Subject: 9 Date: / /

فاصله هوایی	DC	AC	ضربه
۱cm	V_1	V_1'	V_1''
۲cm	V_2	V_2'	V_2''
۳cm	V_3	V_3'	V_3''
۴cm	V_4	V_4'	V_4''

در ولتاژ DC چون ولتاژ ثابت است زمان لازم برای جرقه زنی را داریم.

در ولتاژ AC زمان لازم برای جرقه زنی را تقریبا داریم.

ولی در ولتاژهای ضربه، زمان لازم برای جرقه زنی را نداریم.

پس جدول بزرگی ولتاژهای AC، DC و ضربه فرق دارد.

در حالت دوم که فاصله در پلاریته های مختلف ولتاژ DC نباید ولتاژ شکست زیاد فرق کند. اول در پیوزن هیچ فرق مشهود است

استقامت الکتریکی هوا به چگالی هوا بستگی دارد. مستقیم ← یعنی با افزایش چگالی نسبی، استقامت الکتریکی افزایش می یابد

چگالی نسبی $\delta = \frac{P}{P_0} \frac{273+t_0}{273+t} = \frac{P}{P_0} \frac{T_0}{T}$

فشار زیادتر ← افزایش استقامت الکتریکی ← پس چگالی نسبی بیشتر

سوتعداد مقره ها این بیشتر است چون در ارتفاع فشار کمتر است

ولتاژ شکست $V_d = K_d V_{d_0}$ در شرایط هوای فشار ۱ atm، دمای ۲۰°C و چگالی نسبی δ

عوامل تاثیر گذار بر استقامت الکتریکی $V_d = \delta V_{d_0}$

کاملا

رطوبت همیشه آن یعنی همیشه گاز مالکه.

۱. با افزایش رطوبت، استقامت افزایش می یابد ولی در عمل چون بار اضافه آن نیست و دارای زوایا گاز است، استقامت کاهش می یابد.

۲. تاثیر رطوبت در میدان های یکنواخت بیشتر است.

۳. پلاریته روی استقامت الکتریکی تاثیر دارد.

Shamime Danesh

www.iran-ieee.com

Subject:..... Date: / /

۴. رشته شیع ها تابش اشعه ی نورانی بخصوص ماورای بنفش را شدیدا تحت الکترونی تأثیر دارد چون نور انرژی وارد می تواند

زرات را برانگیزه کند و استقامت الکتریکی را کاهش می دهد.

۵. زرات پراکنده در هوا نیز می توانند بر استقامت الکتریکی تأثیر بگذارند و آن را کاهش دهند.

اندازه گیری ولتاژ AC

PT:

کانه
اولیه
ثانویه
V

$\frac{q}{t} = C V \rightarrow V = \frac{q}{C}$

$q = I t$

تقسیم ولتاژ:

خازن ها برعکس امپدانس شان ولتاژ دارند.

برای مقاومتی برعکس خود امپدانس هاشان ولتاژ دارند.

CVT

مکانیزم است برای جبران سازی اثر خازنی استفاده نوار

C_1 $\frac{1}{jC_1\omega}$
C_2 $\frac{1}{jC_2\omega}$
V

۱:۱ یا کاهنده است

$V_2 \simeq V \frac{C_1}{C_1 + C_2}$

اگر از ۱ با این ترانس برای ایزوله کردن تجهیز اندازه گیری است.

چون ممکن است اتصال کوتاهی در ثانویه بوجود آید که باعث آسیب به تجهیز خواهد شد.

$V_{dc} = \frac{V_{max}}{\pi}$

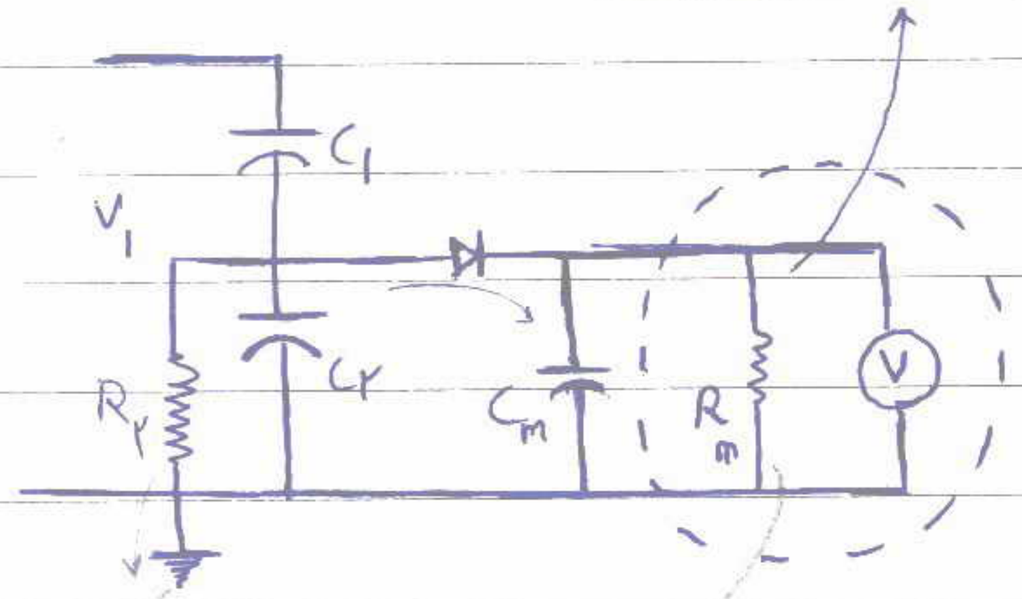
وسایل اندازه گیری یا موثر rms است یا متوسط mean که می توان از رابطه ی $V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$ استفاده کرد چون ممکن ولتاژ سینوسی کامل نباشد وی از طرفی ما یک ولتاژ را لازم داریم چون:

عایق ها عمل شان با یک ولتاژ رابطه دارد نه با متوسط ولتاژ.

Shamime Danesh

www.iran-ieee.com

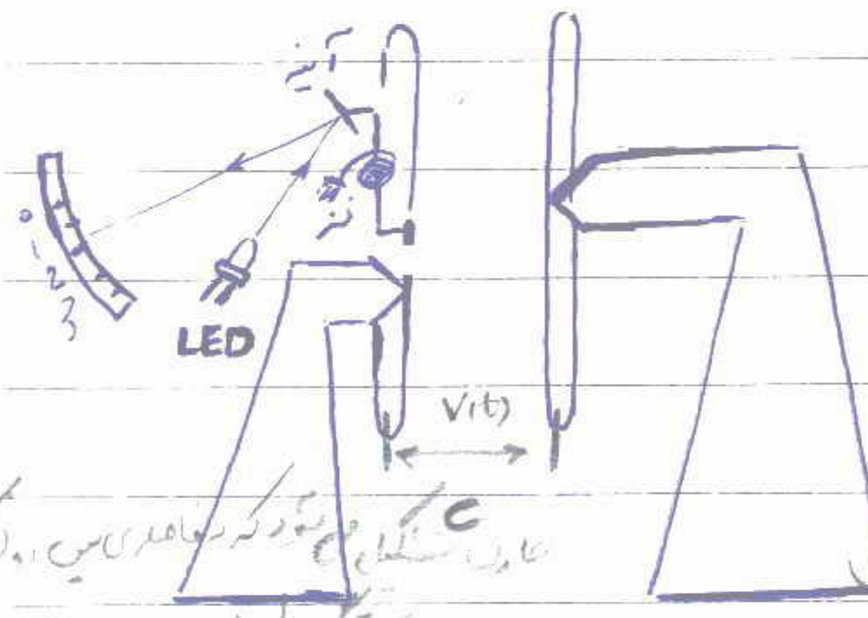
بار مقاومت خوشتاق یا مقاومتی خود ولتمتر



این مدار برای اندازه‌گیری یک ولتاژ است

R_2 کمتر بار لازم را تأمین می‌کند این مقاومت برای بستن مدار لازم است.

اندازه‌گیری ولتاژ توسط ولتمتر الکترواستاتیک:



می‌توانند برای اندازه‌گیری ولتاژ AC و هم ولتاژ DC کاربرد.

آینه را اندازه α بچرخد عقربه‌ی به اندازه 2α می‌چرخد و هر چه فاصله بیشتر باشد دقت اش بیشتر خواهد شد.

$$W(t) = \frac{1}{2} C V^2(t)$$

$$F = -\frac{1}{2} \frac{dC}{dx} V^2(t) \qquad C = \frac{\epsilon A}{d-x}$$

$$F = -\frac{dW}{dx} \qquad |F| = \frac{\epsilon A V^2}{2}$$

مقدار متوسط مجذور = مجذور rms

Shamime Danesh

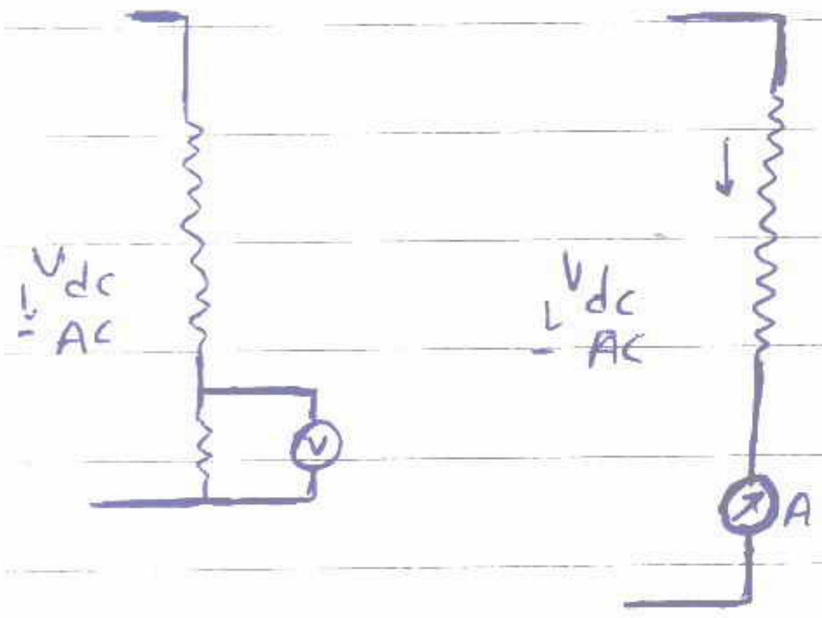
www.iran-ieee.com

Subject:..... Date: / /

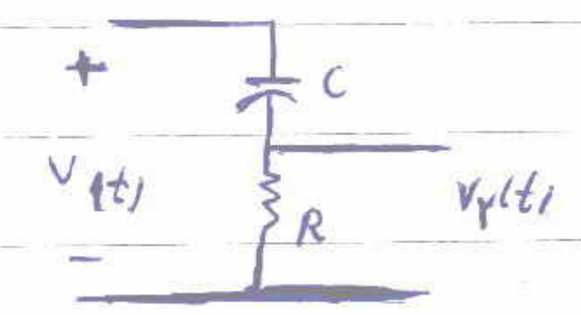
اندازه گیری ولتاژ زیاد به کمک اندازه گیری جریان:

ولتاژی را که نمی‌توان به صورت مستقیم با آمپرمتر اندازه گرفت

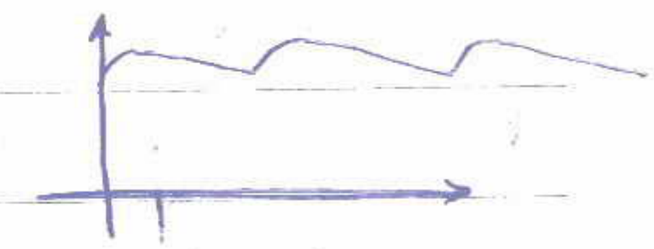
می‌توان معمولاً منبع یا بار هم مؤثر شد



اندازه گیری ناخواسته ولتاژ دیود رسیل:



$$V_R(t) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V(t) = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} V(t)$$

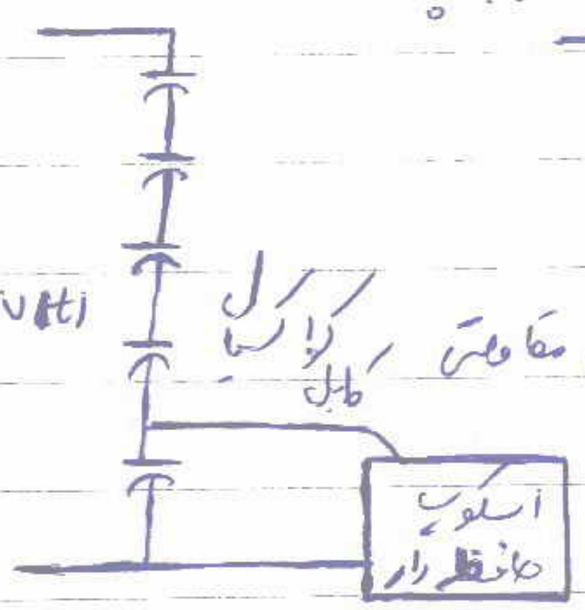


برای دیود dc کامل، اگر $f = 0$ یعنی $\omega = 0$ → $V_R(t) = 0$ → رسیل = 0

یعنی بخش dc روی خازن افتاد

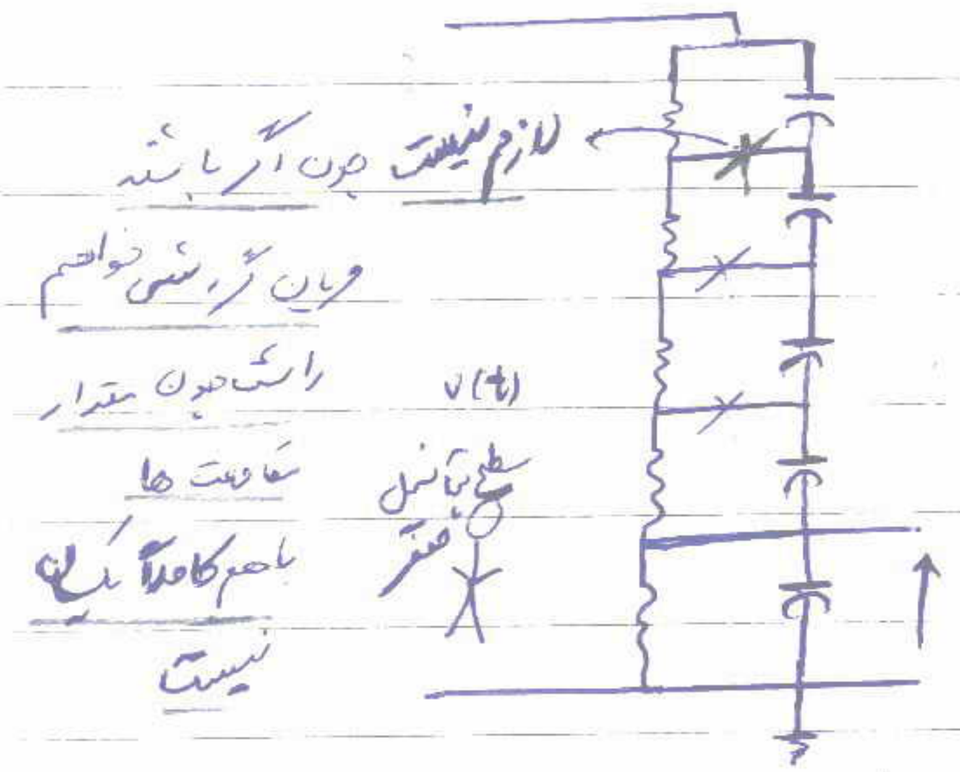
و بخش AC روی مقاومت به شرطی خازن خیلی کم نباشد $j\omega CR \gg 1 \longrightarrow V(t) \cong V_R(t)$

اندازه گیری ولتاژ خروجی:



۱- مقسم خازنی

۲- مقسم خازنی مقاومتی



دقت اثر بیشتر است چون سطح تماس خازن بهتری ایجاد می‌کند و تأثیر محیط اطراف کمتر است

Ghamime Dane

www.iran-ieee.com

→ خازن های سرامیکی می‌توانند برای ولتاژهای هرچه sharp اند مثل اتصال کوتاه عمل نمایند.

وضعیت میدان های الکتریکی در عایق‌ها:

الکتریکی اندازه‌گیری
شدت میدان برای عایقی استفاده می‌شود نه ولتاژ.

$$\eta = \frac{E_{mean}}{E_{max}} = \frac{V_b}{E_{max}\cdot d} = \frac{V_b}{V_{max}}$$

ضریب استفاده شوایر

V_b ولتاژی است که میدان را در این نقطه E_{max} می‌کند

$$E_{mean} = \frac{V_b}{d} \quad \left(\text{ولتاژ بین دو الکترود} \div \text{فاصله‌ی دو الکترود}\right)$$

$$E_{max} = \frac{V_{max}}{d} \quad \left(\text{میدان ماکزیمم} \div \text{فاصله‌ی دو الکترود}\right)$$

میدان متوسط: میدانی که در تمام نقاط یکسان است

حتی چقدر میدان بین الکترودها را یکنواخت‌تر کنیم ولتاژ قابل تحمل عایق بالاتر خواهد بود. مثلاً از ۶ به ۱۰ برابر

$$V_b = E_{max}\cdot d\cdot \eta$$

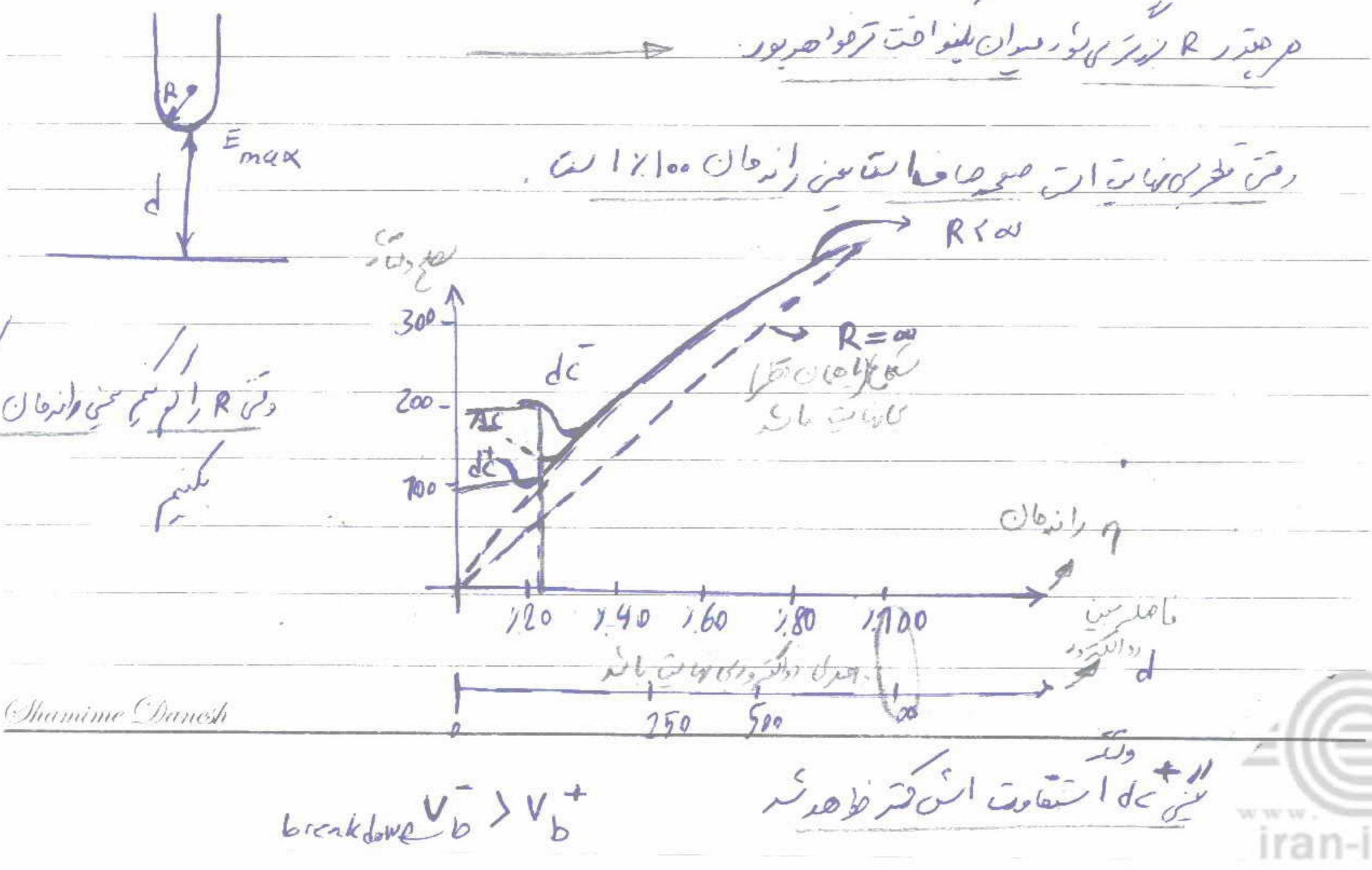
شدت میدانی که هوا می‌تواند در فضای بین دو الکترود تحمل کند

$$V_b = 26.6 \ \text{kV/cm} \rightarrow \%50$$

با اثر هاله

هر چقدر R بزرگتر باشد میدان بیشتر خواهد بود.

وقتی طول آزاد صحیح حاصل شود یعنی راندمان ۱۰۰٪ است.



وقتی R را بی‌نهایت می‌کنیم یعنی راندمان را

dc^+ استقامت اش کمتر ظاهر شد

$V_b^- > V_b^+$ breakdown

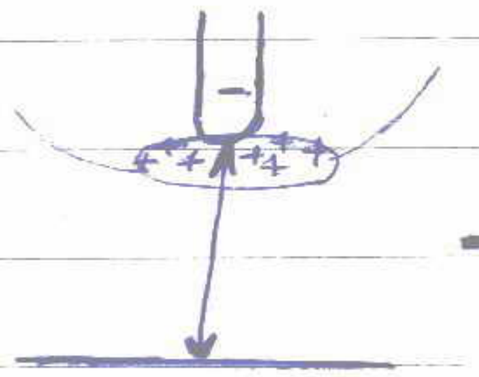
Shamime Danesh
www.iran-ieee.com

Subject:...(...)... - جایی که پلاریتی بردار منفی باشد (جهت الکترون‌ها) یعنی V_2 Date: / /

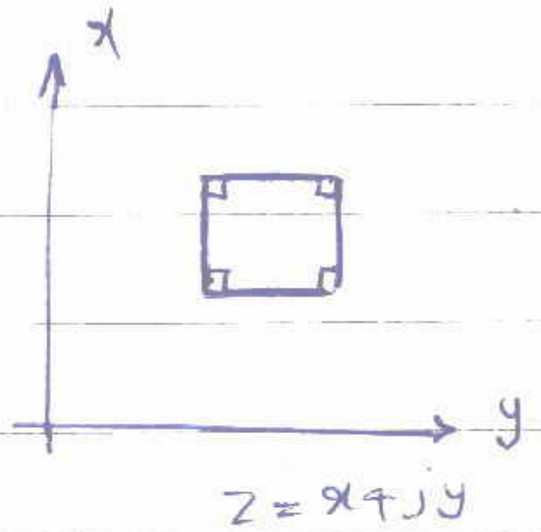
چون یون‌ها وزن‌شان بیشتر است و سرعتشان کمتر است پس یک تجمع از یون‌ها را در اطراف سوزن خواهیم داشت.

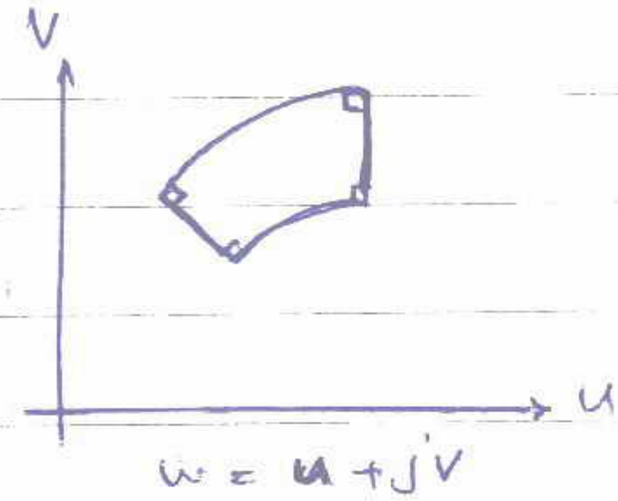
- چون آنقدر ارتفاع بزرگ‌تری سوزن حرکتش به خوردی خود اضافه خواهد بود و تجمع یون‌ها تأثیری نخواهد

راست.



روش اول: نگاشت هندسی





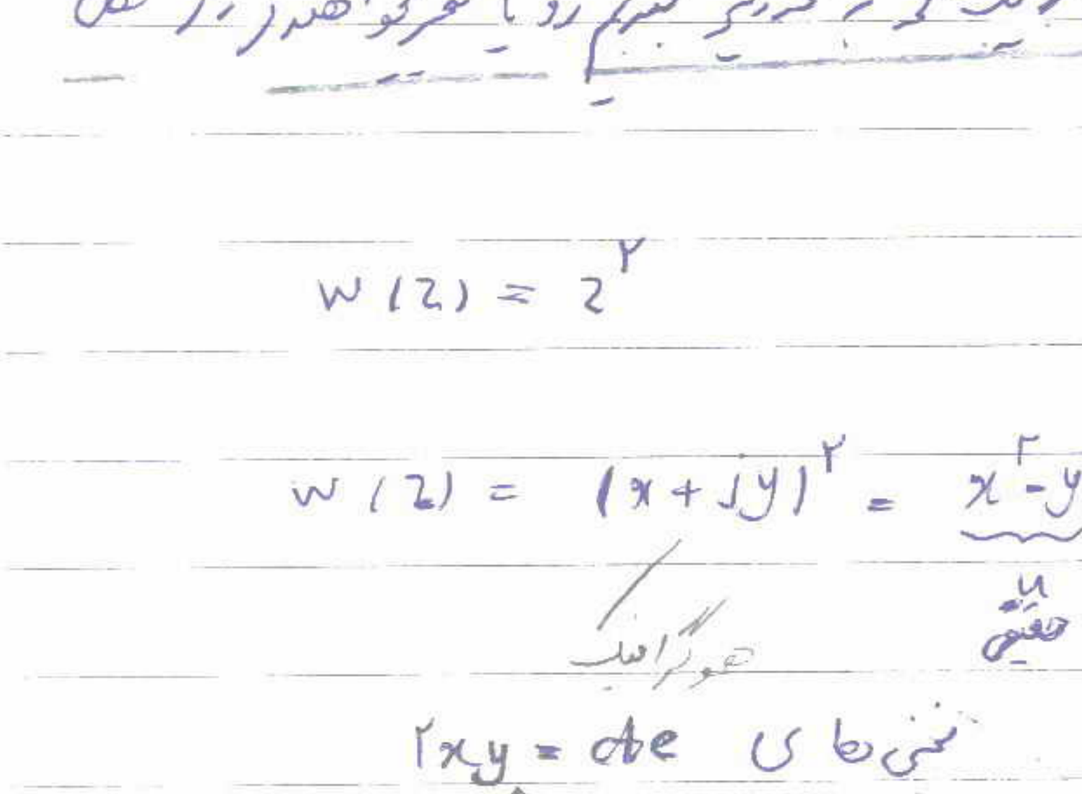
اگر تابع تحلیلی داشته باشیم و توسط آن تابع یک شکل را از یک صفحه به صفحه دیگر ببریم زاویا تغییر خواهند کرد، شکل امکان دارد تغییر کند!

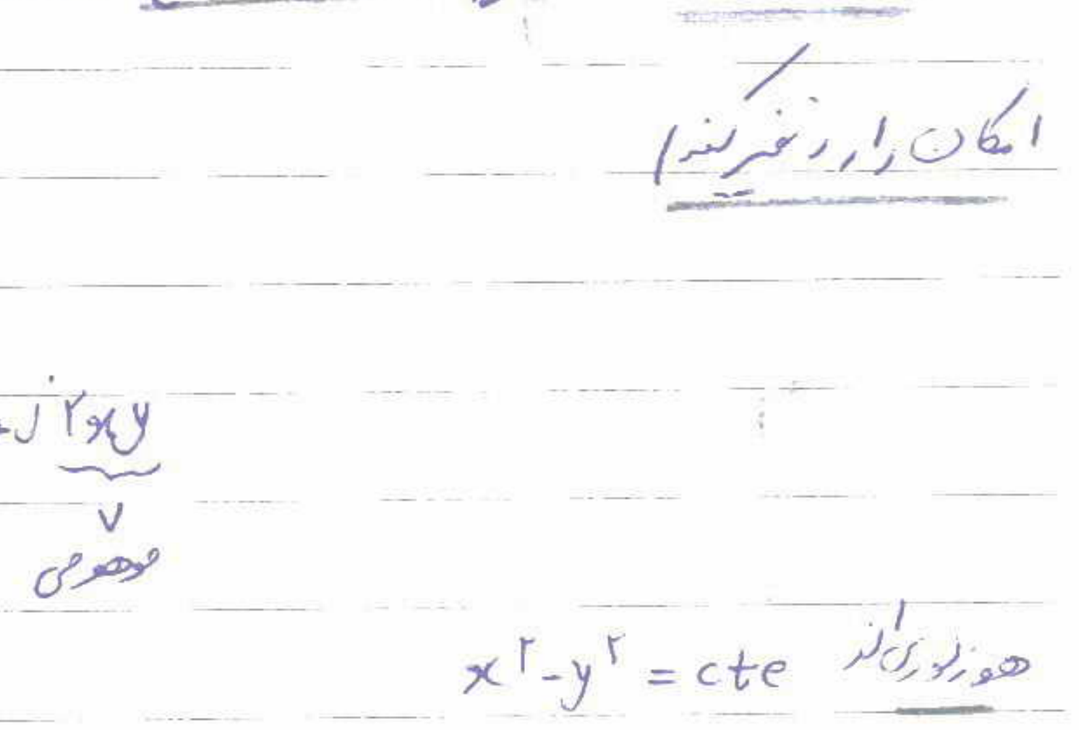
$$w(z) = z^2$$

$$w(z) = (x+jy)^2 = \underbrace{x^2 - y^2}_{u} + j\underbrace{2xy}_{v}$$

حقیقی — موهومی — همگرا است

خطوط $2xy = ctc$ هذلولوی اند — هذلولوی اند $x^2 - y^2 = ctc$





Shamloue Danesh

www.iran-ieee.com

$w = \arcsin \frac{z}{a} \longrightarrow z = a \sin w$

$z = x + jy = a \sin(u + jv) =$

$= a \sin u \cos jv + a \cos u \sin jv$

$= a \sin u \cosh v + ja \cos u \sinh v$

$x = a \sin u \cosh v$

$y = a \cos u \sinh v$ ←

$\cos jv = \cosh v$

$\sin jv = j \sinh v$

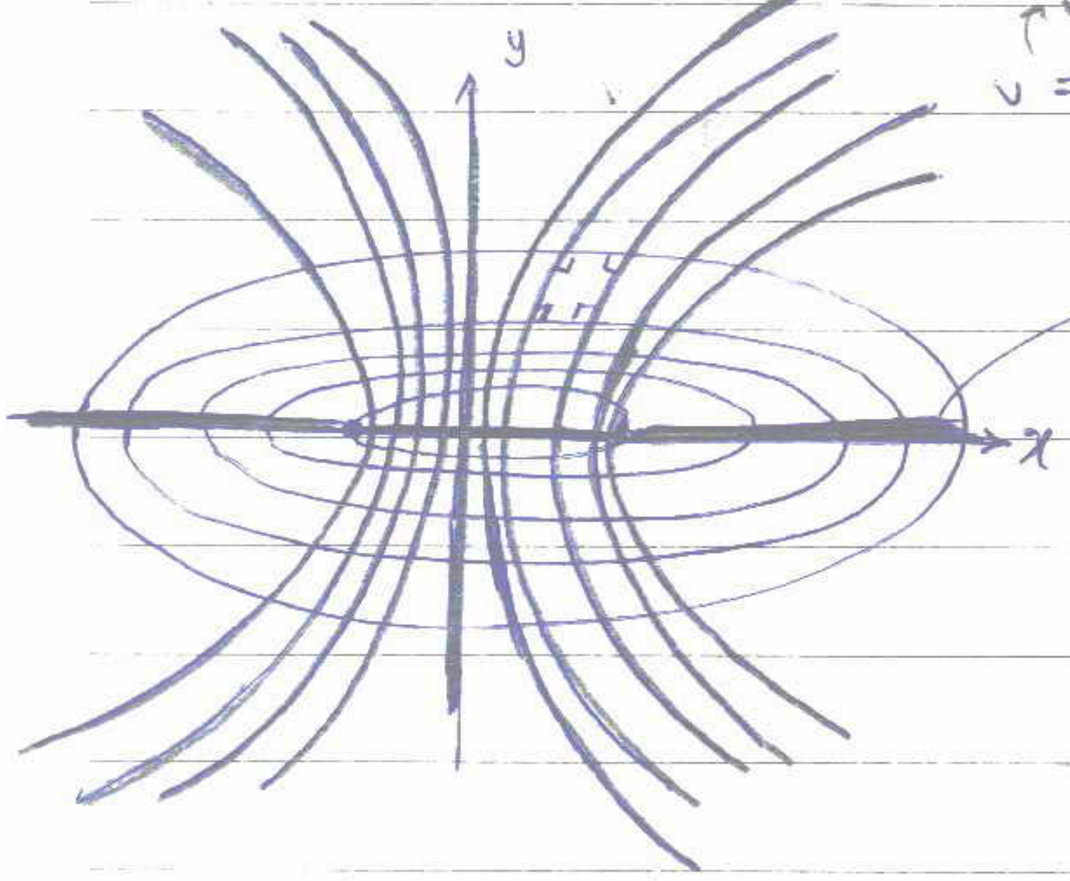
$\left(\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \quad , \quad \cosh^2\theta - \sinh^2\theta = 1 \right)$

$\sin^2 u + \cos^2 u = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{a^2 \cos^2 hv} + \frac{y^2}{a^2 \sin^2 hv} = 1$

$\frac{x^2}{\cos^2 h u_1} + \frac{y^2}{\sinh^2 v} = a^2$

$u = cte$ ↑ ثابت $\quad$ $v = cte$ ↑ ثابت

$v = cte$ خم‌های بیضی‌ای



میدان بین دو صفحه

میدان بین دو مخروطی

میدان بین دو هذلولوی

$\cosh^2 v - \sinh^2 v = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{a^2 \sin^2 u} - \frac{y^2}{a^2 \cos^2 u} = 1$

$\frac{x^2}{\sin^2 u} - \frac{y^2}{\cos^2 u} = a^2$

هذلولوی $x^2 - y^2 = cte$

$u = cte$

← برای کردن این تابع تحلیلی کار سختی است برای شکل‌های متداول در طبیعت این کار را انجام داده‌اند

Ghamime Darvish

www.iran-ieee.com

Subject:..... Date: / /

$$Z = \frac{a}{\pi}(W + 1 + e^{W})$$

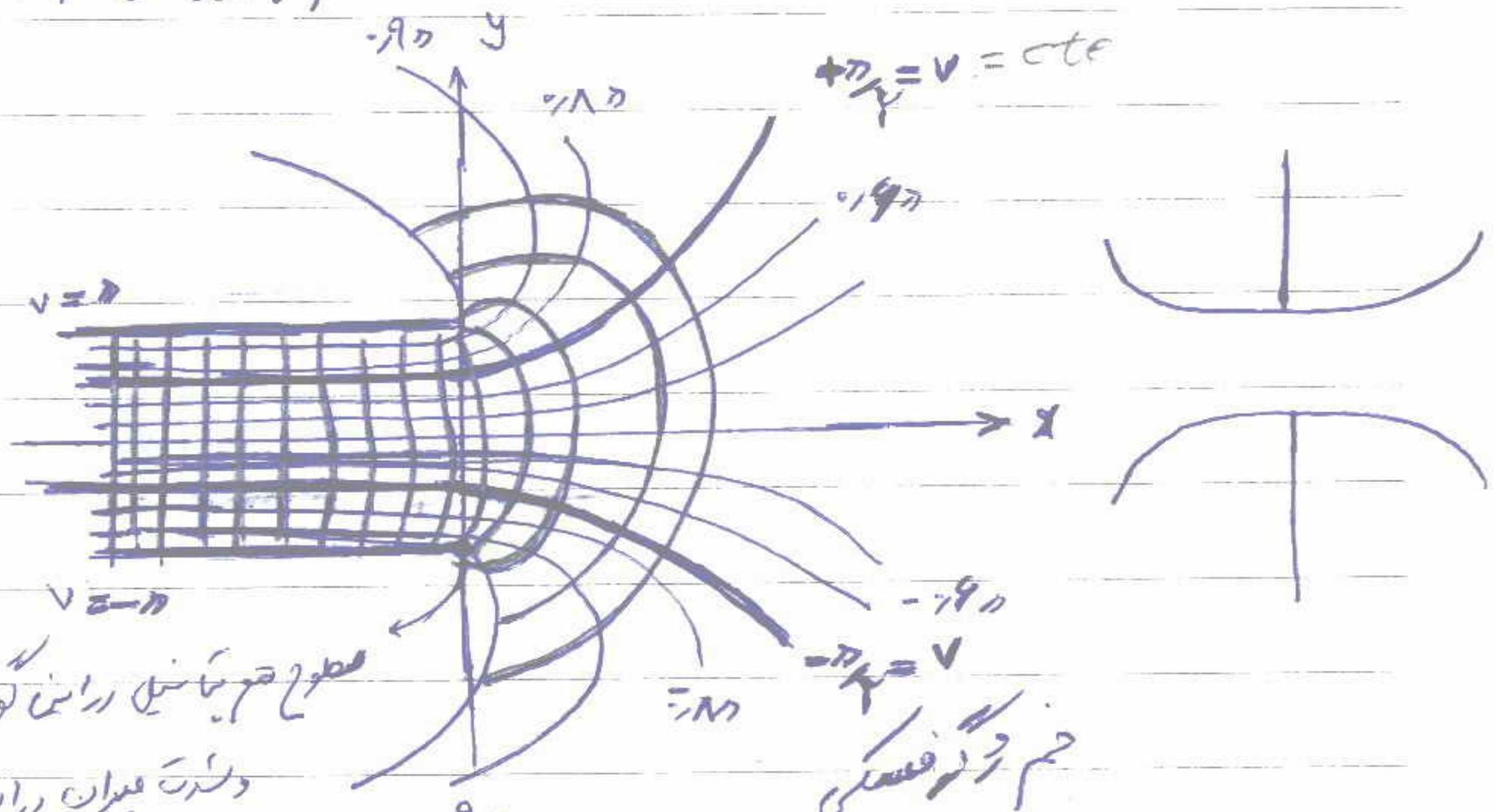
$Z = x + jy$, $W = u + jv$

(Maxwell) ماکسول

نگاشت کانفورم

$$x = \frac{a}{\pi}(u + 1 + e^{u}\cos v)$$

$$y = \frac{a}{\pi}(v + e^{u}\sin v)$$



سطوح هم پتانسیل را نیز گوشه‌هایی هم تراکم می‌شوند
و شدت میدان در این نقاط خیلی زیاد است

جسم ژوکوفسکی

مثال:

هر چه بیشتر از لبه حمله دور شویم میدان یکنواخت می‌شود

بهترین جواب برای شدت میدان یکنواخت بدست می‌آید که برای ایجاد میدان یکنواخت بهترین هندسه، هندسه‌ای است که شکل جسم ژوکوفسکی

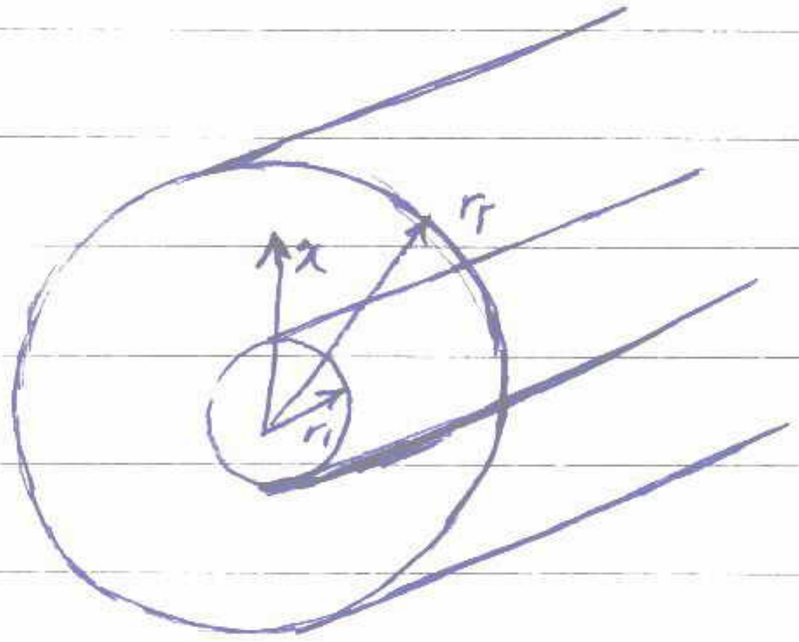
از هندسه‌های $a = 1$ و $a = 2$ هم می‌توان برای میدان یکنواخت استفاده کرد اما هندسه بزرگتر ظاهر شده و هزینه زیاد خواهد شد و هندسه‌های $a = 0.8$ و $a = 0.5$ صحنه‌ای خواهند شد ولی میدان یکنواخت نخواهد بود

ولی جسم ژوکوفسکی بهترین حالت بین این دو حالت است.

www.iran-ieee.com

استفاده از
۲ روش شکل های ساده

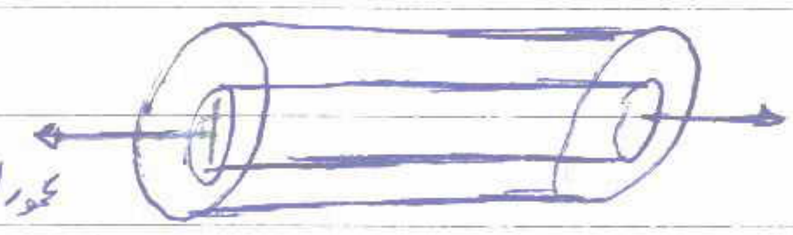
میدان الکتریکی روستوانه توخالی و متحدالمرکز



$$\oint D.ds = \sum q$$

$$۲\pi x . \epsilon E_x = \sum q$$

روا استوانه متحدالمرکز $E(x) = \dfrac{Q/l}{۲\pi\epsilon}\dfrac{۱}{x} = \dfrac{V}{\ln|r_۲/r_۱|}\dfrac{۱}{x}$ ← با خطی



بخورات است
پس $\oint D.ds = 0$ می شود

$$V_۱ - V_۲ = \ominus \int_{r_۱}^{r_۲} E.dr$$

$$-V = -\frac{q}{۲\pi\epsilon l}\int_{r_۱}^{r_۲}\frac{dr}{r} = \frac{q}{۲\pi\epsilon l}\ln\frac{r_۲}{r_۱}$$

روکره متحدالمرکز

$$۴\pi x^۲ . \overrightarrow{\epsilon E_x} = Q \longrightarrow E(x) = \frac{Q}{۴\pi\epsilon}\frac{۱}{x^۲} = \frac{V}{(R_۲-R_۱)/R_۱R_۲}\frac{۱}{x^۲}$$

در روا استوانه :

اگر $r_۲ = r_۱$ ← E_{max} افزایش نامحدود یابد ($\ln ۱ = ۰$)

اگر $r_۱ \to ۰$ ← E_{max} افزایش نامحدود یابد ($\frac{۱}{۰} = \infty$)

$$E_{max} = \frac{V}{\ln\frac{r_۲}{r_۱}} \times \frac{۱}{r_۱}$$

← پس $r_۱$ را چقدر انتخاب کنیم که بازای آن $r_۲$ ، رشد میدان ماکزیمم (E_{max}) مینیمم شود؟

$$\frac{dE_{max}}{dr_۱}\Big|_{r_۲=cte} = ۰ \longrightarrow \boxed{r_۲/r_۱ = e = ۲,۷}$$

نسبت شعاع بیرونی به شعاع داخلی راضی ۲,۷ است

و این نکته در تمام کابل ها، سیستم های دزدگیر هم رعایت می شود

$\frac{d}{dx}\ln u = \frac{u'}{u}$

Shamime Danesh

www.iran-ieee.com

Subject:..... در دو کره متحدالمرکز : Date: / /

طنزی پیچیده تا شعاع آن بیشتر شود / همچنین انحنا وان بیشتر شود

$$E_{max} = \frac{V}{\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}} \frac{1}{R_1^2}$$

اگر $R_1 = \infty$ ← $E_{max} = \infty$

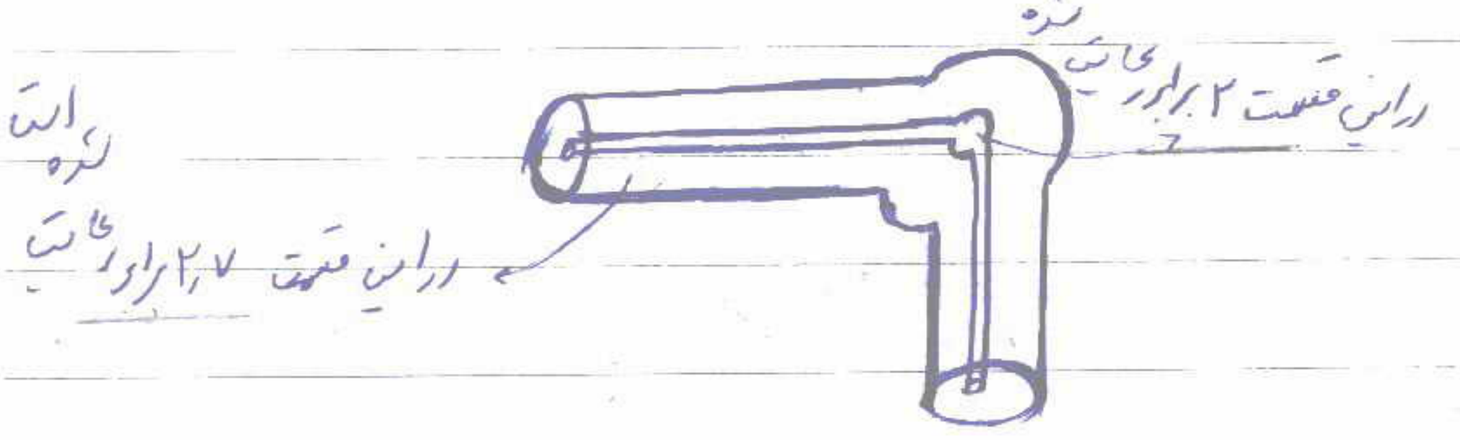
اگر $R_1 = R_2$ ← $E_{max} = \alpha$

$R_1 \to \infty$ ↓ $R_1 \to \infty$

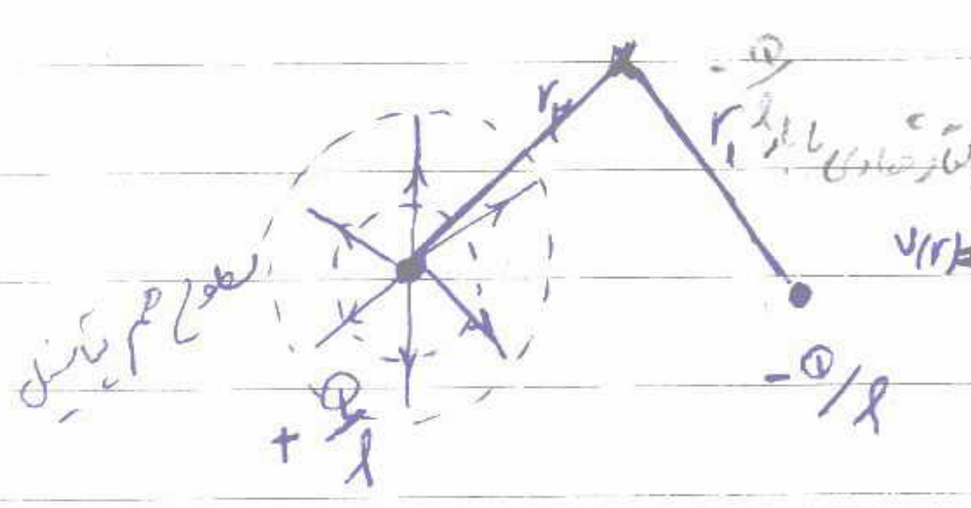
$E_{max} = \frac{V \times \infty}{R_2 - R_1 = cte} = \infty$ × α

$$\left.\frac{d E_{max}}{d R_1}\right|_{R_2 = cte} = 0 \longrightarrow R_2 = 2R_1$$

ریست‌های GIS :



میدان بین دو هادی موازی :

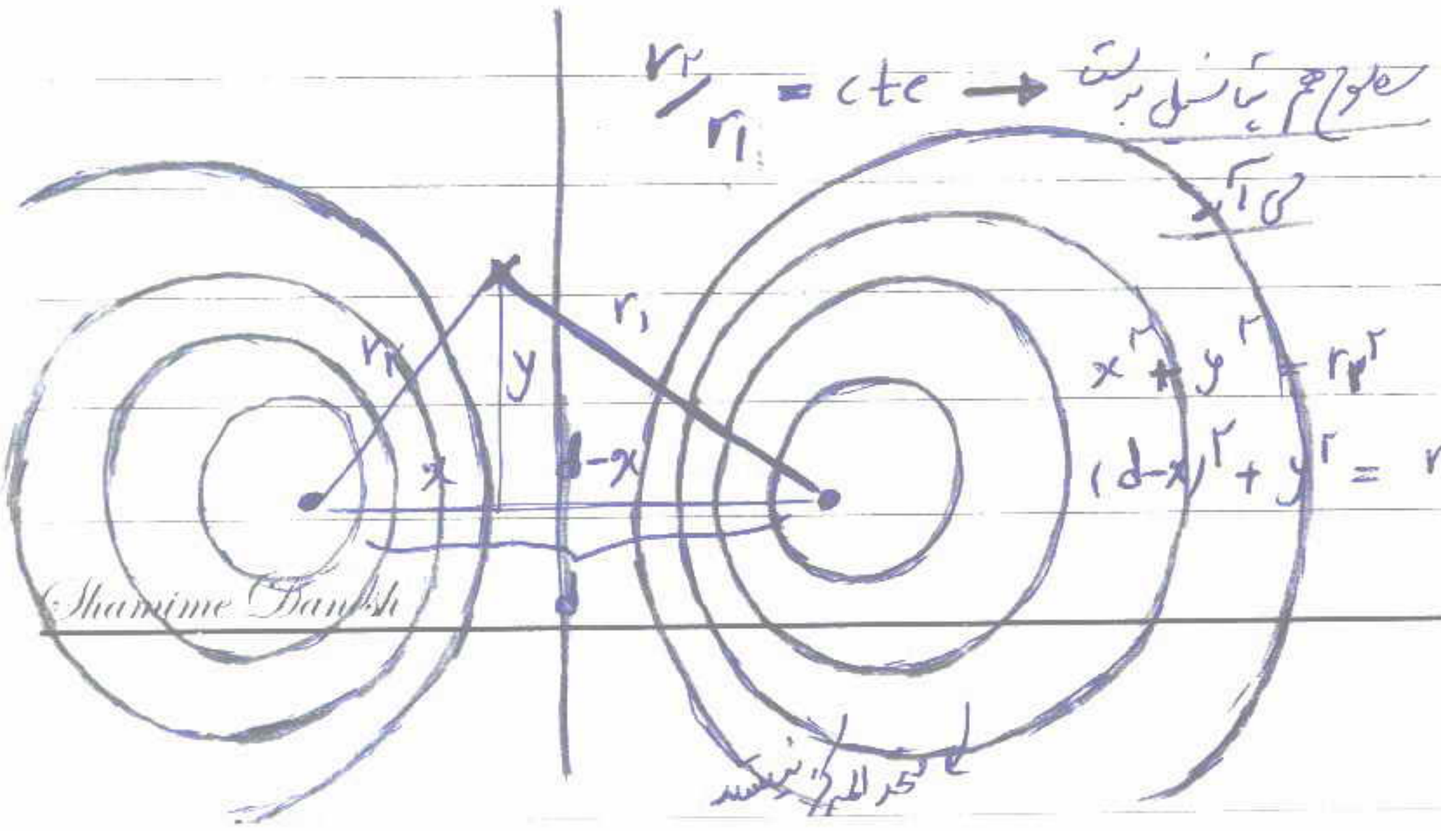


$$V(r) = -\frac{Q/l}{2\pi\epsilon} \ln r + K$$ ← با انتخاب یک مقدار برای K پتانسیل بدست می‌آید

$$V(r) = -\frac{Q/l}{2\pi\epsilon} \ln r_1 + K + \frac{Q/l}{2\pi\epsilon} \ln r_2 + K$$

$$V(r) = \frac{Q/l}{2\pi\epsilon} \ln r_2/r_1 + 2K = \frac{Q}{2\pi\epsilon l} \ln r_2/r_1$$

$r_2/r_1 = cte$ ← سطوح هم پتانسیل برابر



www.iran-ieee.com

Subject: ۱۴ Date: / /

$$\frac{(d-x)^2+y^2}{x^2+y^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = k^2 \longrightarrow \left(x+\frac{d}{k^2-1}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{kd}{k^2-1}\right)^2$$

معادله دایره‌ای که کره‌ی $(0, 0, \frac{d}{k^2-1})$ است

شعاع $\frac{kd}{k^2-1}$

روش های تعیین میدان و پتانسیل (اندازه‌گیری)

۱- استفاده از ترسیم میدان روی کاغذ کربن دار

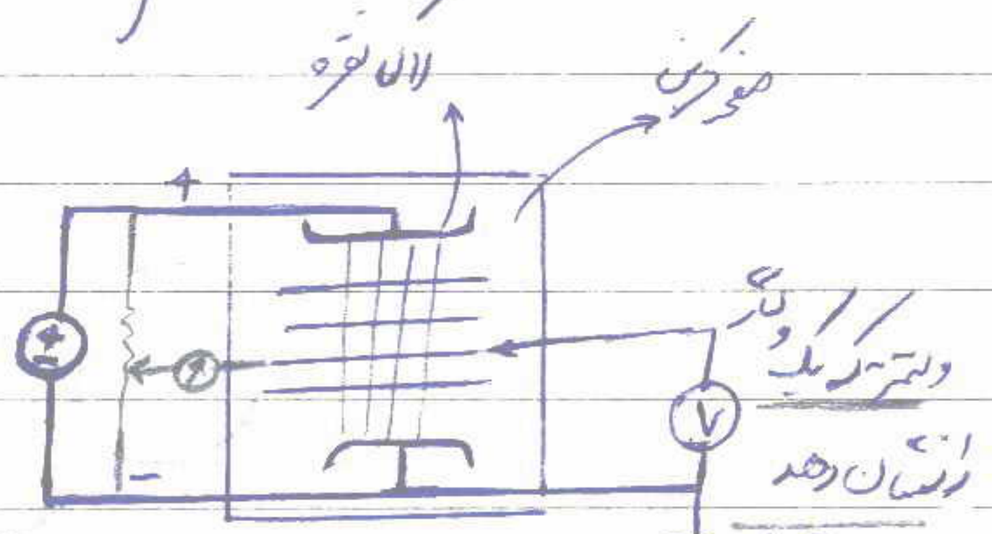
فقط خاصیت میدان های دوبعدی و یا میدان هایی که در یک جهت ثابت می‌مانند.

برای یک دی الکتریک

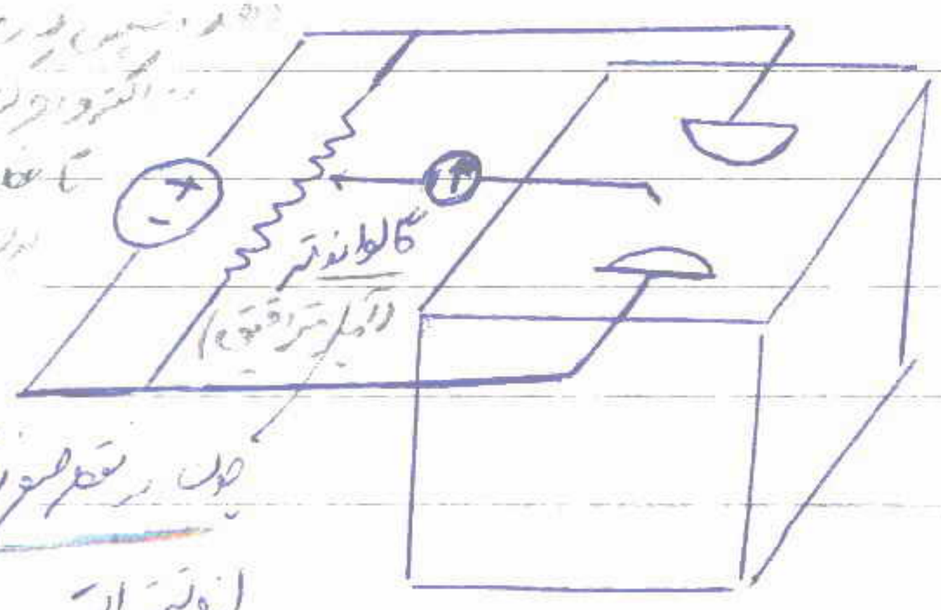
$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ $\quad \Phi = \int D \cdot dA$ $\quad div\, \vec{D} = 0$

برای یک هادی

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$ $\quad I = \int J \cdot dA$ $\quad div\, \vec{J} = 0$



۲- استفاده از پدیده الکترولیت: مناسب برای الکترودهای نسبتاً بزرگ



جنس رسانا: مس یا نقره

Shamime Danesh

www.iran-ieee.com

وی اینجوری راه نقص هم وجود را رد می‌کنند چرا ← بر نظری رسد این ماشین‌ها اینگونه خواهند بود ✓

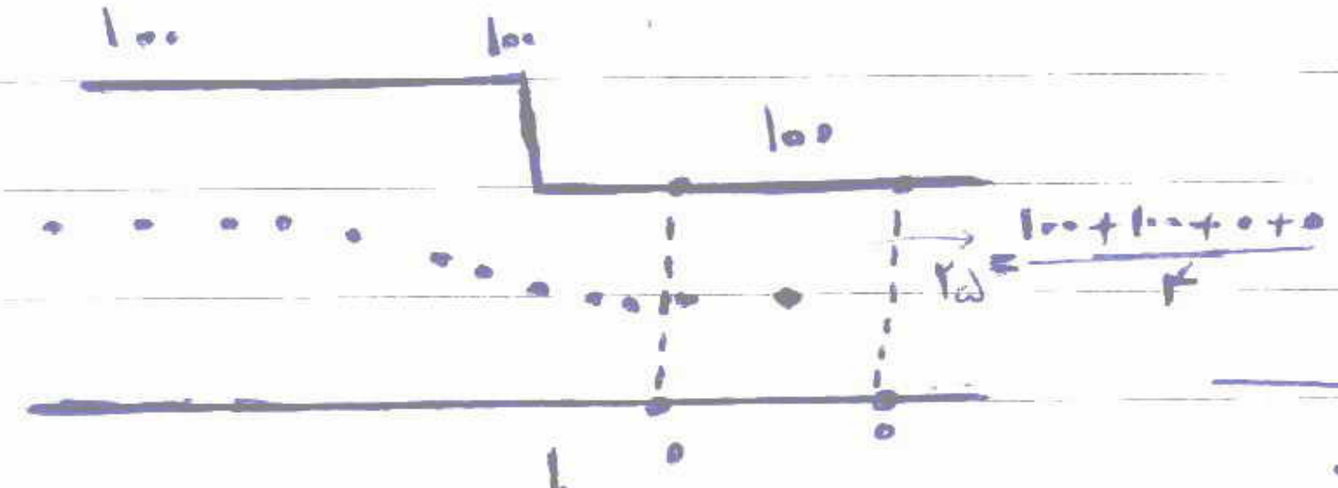
سرعتی که گویند چرا ← در حال این ماشین‌ها اینگونه خواهند بود ✗

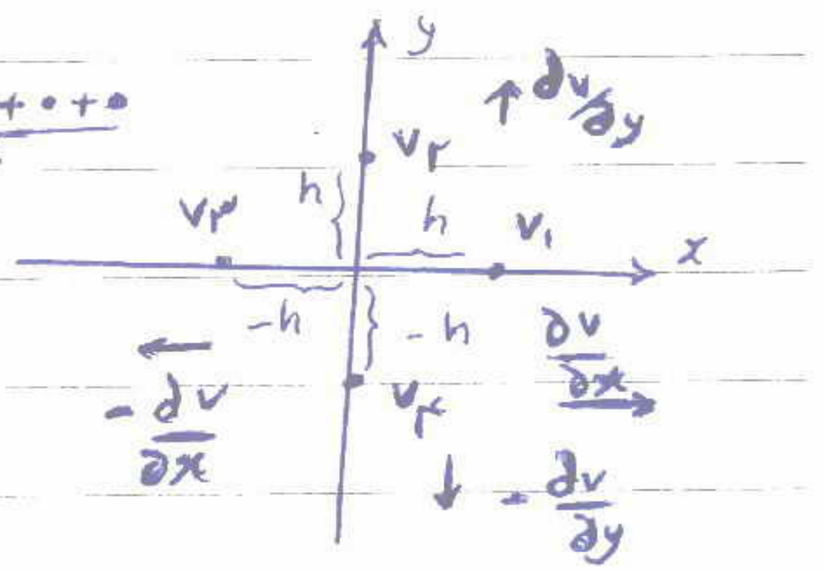
Subject:..... Date: / /

۳- استفاده از پرکاه : وسیله‌ای رو حقی با وزن کم است — پرکاه در راستای خطوط حرکت می‌کند

۴- اجزای نگردور

روشی





$$V_1 = V_0 + \frac{\partial v}{\partial x} dx \quad (dx = h)$$

این فرمول‌ها وقتی درست است که این فاصله‌ی h خیلی کوچک باشد نگرنه باید مشتقات مرتبه بالاتر را هم بنویسیم

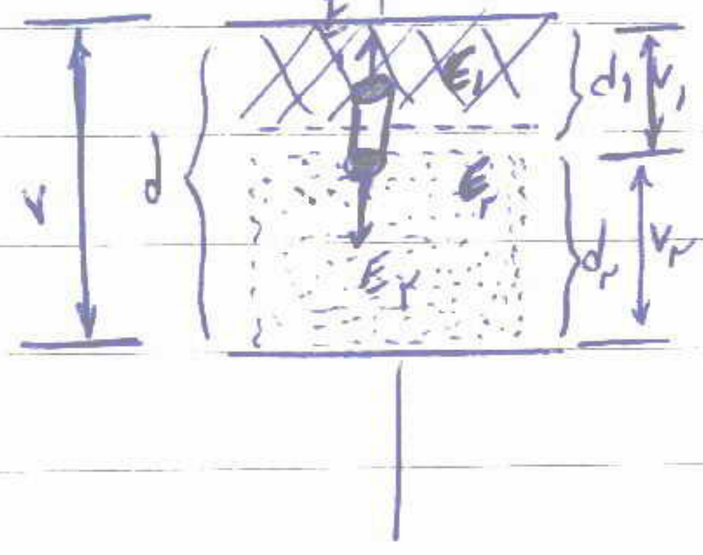
$$V_2 = V_0 + \frac{\partial v}{\partial y} dy \quad (dy = h)$$

$$V_3 = V_0 + \frac{\partial v}{\partial x} dx \quad (dx = -h)$$

$$V_4 = V_0 + \frac{\partial v}{\partial y} dy \quad (dy = -h)$$

$$V_0 = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4}{4}$$

میدان الکتریکی در محیط‌های مختلف : — رفتار میدان در سطح جدایی عبورات :



هدایت مکانیزه آن یعنی $\sigma = 0$ پس عبور جریان ممنوعه است

در مرز دو محیط $\sigma = 0 \rightarrow \oint D \cdot ds = \sum q = 0$ این مرز بار آزاد وجود ندارد.

چون جهت شار مخالف هم است

$$S D_1 - S D_2 = 0$$

$$D_1 = D_2$$

$$\epsilon_1 \vec{E}_1 = \epsilon_2 \vec{E}_2 \quad \leftarrow \quad \left(\frac{\vec{E}_1}{\vec{E}_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \right)$$

www.iran-ieee.com

صفحه با وزنه‌ی کاغذ ۱ رقمی جلوی چشم سینه‌باشه، رنگ بلوز، حداکثر ۵ جمله رد خط، حرفون نگذاره ارباد ریوسیت

Subject: ۱۵ Date: / /

$$V = V_1 + V_2 = E_1 \cdot d_1 + E_2 \cdot d_2 = E_1 d_1 + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 d_2$$

$$E_2 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1$$

$$\boxed{E_1 = \frac{V}{d_1 + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} d_2}} \quad (2)$$

$$\boxed{E_2 = \frac{V}{d_2 + \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} d_2}} \quad (1)$$

۱/ نقطه

اگر خازن سری عایق نباشد: $\boxed{E = \frac{V}{d_1 + d_2}}$

if $\epsilon_2 \gg \epsilon_1 \longrightarrow \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = 0$, $\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \approx \infty$

← خریبی الکتریک هیچ ربطی به استقامت عایق ندارد

و همه‌ی عایق‌ها ضریبی‌ی الکتریک نسبی‌شان بزرگتر از ۱ است و ضریبی‌ی الکتریک‌شان خیلی بزرگ است

بیشتر خواهد شد

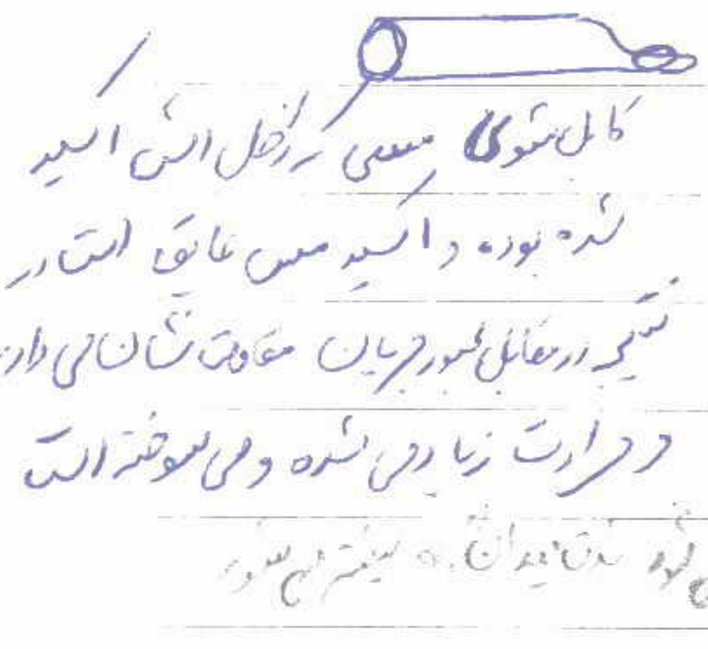
با وجود عایق‌ها شدت میدان در آن لایه‌ها کمتر می‌شود

با وجود عایق‌ها شدت میدان در این لایه‌ها خیلی بیشتر از هوا

شدت میدان در این لایه‌ی بازه هوا خیلی بیشتر از

شدت میدان هوای کناری که فقط از هوا درخود دارد

عایق استفاده کرده برهمین دلیل در عایق کاری باید دقت کنید هوا نبرد!



Shamima Danesh

www.iran-ieee.com

اگر دو عایق را بصورت مخلوط در بیاوریم تا زمانی که در سطح ماکروسکوپی مخلوط شده باشند رابطه فنی را خواهد داشت

ولی اگر خیلی خوب مخلوط شده باشند که بتوان گفت یک ماده است می‌توان گفت: $D = \epsilon_{res} E$ (منتجه)

$D_1 = D_2$

$D = \epsilon_{result} E = \epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2$ (۳)

$\epsilon_{res} = \dfrac{1}{\frac{(d_1/d)}{\epsilon_1} + \frac{(d_2/d)}{\epsilon_2}}$ $\left(\frac{V}{d}\right)$

d_1 میزانی که از عایق ۱ داریم

d_2 میزانی که از عایق ۲ داریم

$\epsilon_{res} = \dfrac{1}{\frac{V_1}{\epsilon_1} + \frac{V_2}{\epsilon_2}}$

ϵ_1 ← حجم نسبی عایق مقرین

نتایج استفاده از:

$\left(\epsilon_{res} = \dfrac{1}{\frac{v_1}{\epsilon_1} + \frac{v_2}{\epsilon_2} + \frac{v_3}{\epsilon_3} + \cdots + \frac{v_n}{\epsilon_n}}\right)$

v_1 و v_2 و v_3 و ... و v_n حجم نسبی عایق‌های مختلف است.

که الکتریک ϵ_1 و ϵ_2 و ... و ϵ_n می‌باشند.

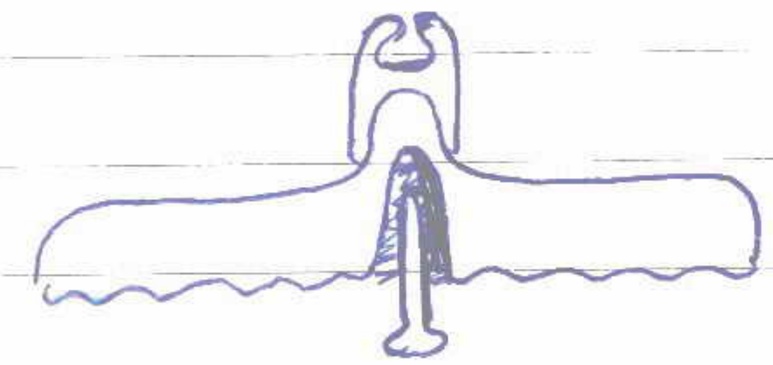
$v_1 + v_2 + v_3 + \cdots + v_n = 1$

$\boxed{\sum v_i = 1}$

دلیل استفاده از مخلوط عایق: چون عایق‌ها خواص مختلفی دارند شاید بعضی‌شان استقامت مکانیکی خوبی دارند

شاید بعضی‌شان استقامت الکتریکی خوبی دارند و ...

کپ فلزی



پین فلزی

www.iran-ieee.com

Subject: 16 برای قابلیت اطمینان ← Date: / /

- هر سه ۲۰kV ، گرفتگ در پست ۴۰۰kV : ۱۵-۱۶ = ۲۳۰/۲۰ + d ↑

کفه

۳۰°

۷

زمین

ولتاژ گام عبارت از ولتاژی بین دو نقطه که فاصله آنها یک متر فرض می‌شود

زاویه حفاظ

سیم زمین

CT است چون سری است

برای این است که از هیچ نقطه‌ای حداقل یک سیم زمین این حفاظ عبور کند

سیم

این حفاظ برای این است که میدان یکنواخت برقرار شود و کابل‌ها روی مقره‌ها یکسان باشد

Spacer

- مقره‌ها چینی یا porcelain است تا اگر باران بیاید یک سطح خیس و یک سطح خشک خواهد بود.

PT است چون موازی است

هم برق‌گیر هم

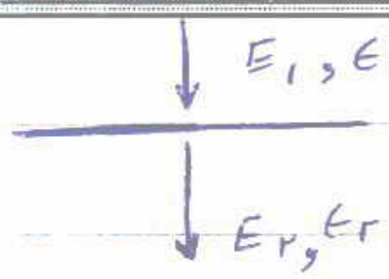
آنتن دکل می‌تواند

این طور در نظر گرفته شود که برای فرار صاعقه

باید در هر جا یک اتصال به زمین داشته باشیم چون اگر اتصال به زمین نداشته باشیم اگر یک فاز اتصال کند ولتاژ دو فاز دیگر ۱۷۳ درصد بالا می‌رود به همین خاطر است که آنها را زمین می‌کنند.

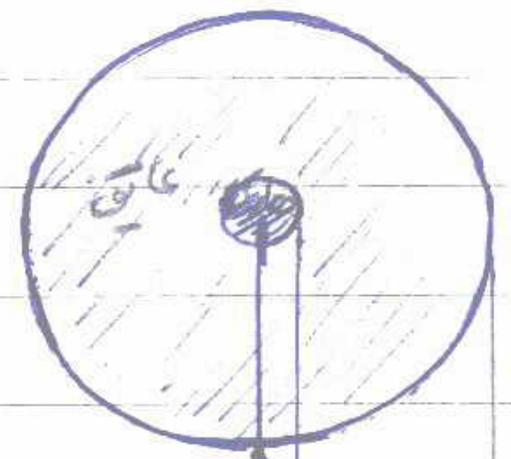
Shamime Danesh

www.iran-ieee.com



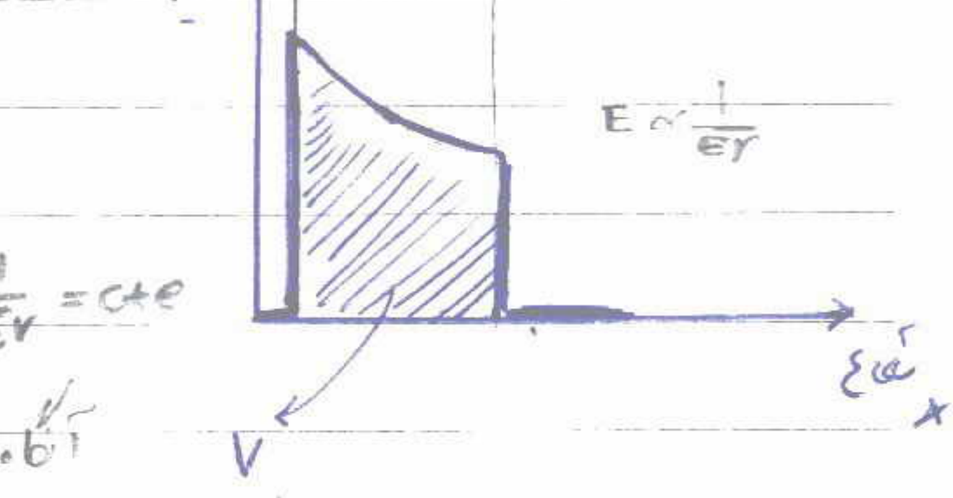
$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

راض هاال کر شوت میدان صفر است.



اگر شیلد را کنار باشیم در بیرون هم میدان صفر است.

$$V = \int_{\text{مسافت نوار}}^{\text{روی رد}} E\,dr$$



$$E \begin{cases} \propto \frac{1}{r} \uparrow \\ \propto \frac{1}{\epsilon} \downarrow \end{cases} \longrightarrow \frac{1}{\epsilon_r} = C \text{ te}$$

آنگاه مقدار ماکزیمم میدان ها با هم برابر می شود

$$\epsilon_1 r_1 = \epsilon_2 r_2 = \epsilon_3 r_3 = \cdots = \epsilon_n r_n$$

بهترین حالت این است:

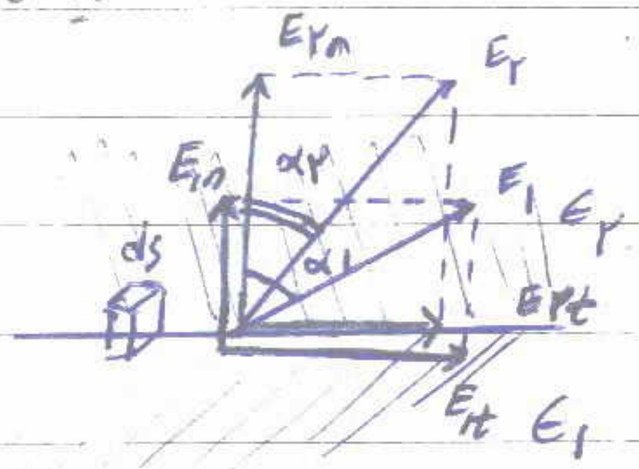
همین حرف در سمت شعاع های بالاتری رد می شود، ϵ را بزرگتر در نظر می گیریم

هرچه تعداد لایه ها بیشتر شود، خطا حاصل کمتر قابل توجه می شود.

$$E(x) = \frac{V}{\epsilon_r \times \sum_{n=1} \left(\frac{1}{\epsilon_n} \ln \frac{r_{n+1}}{r_n} \right)}$$

$\frac{1}{\epsilon_r}$

فرض کنیم میدان در سطح جانبی مخروط ناقص باشد:



اقتدا و ولتاژ این دو نقطه

$$\oint E \cdot d\lambda$$

اصلا مسیر بسته ای ندارد

$$E_{1t}\,dx = E_{2t}\,dx \longrightarrow \boxed{E_{1t} = E_{2t}}$$

موکلفه های میدان!

$$\oint D \cdot ds = \sum q = 0 \longrightarrow$$

چون باری روی سطح نیست

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = -\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

iran-ieee.com

یعنی زاویه ها متوالی قائم باشند ضرب داخلی آنها صفر را حاصل دارد ←

$$\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\frac{E_{1t}}{E_{1n}}}{\frac{E_{2t}}{E_{2n}}} = \frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

خطوط از هم باز می شوند

شکل های زیر را بررسی می کنیم ←

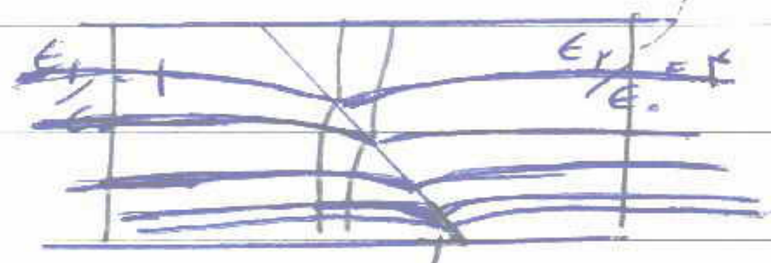
مثال:

این حالت بهتر است چون می دانیم بر یکدیگر در اطراف سنسل

هادی داخلی ست پس در این حالت که خطوط هم تا- خطوط میدان

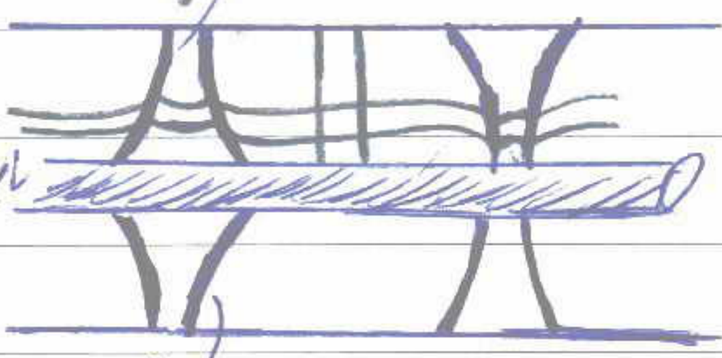
را اطراف هادی گیر هستند، شدت میدان هم

بزرگ است



خطوط هم پتانسیل

نگهدارنده ها



فشردگی خطوط هم پتانسیل

شدت میدان در این حالت بیشترین مقدار را دارد

چون در راه دار، سطوح هم پتانسیل فشرده تر و در نتیجه خطوط میدان

فشرده تر خواهند شد ولی اگر بصورت یکنواخت پرش

می زدیم عایق کمتر آلش می شد پس

شدت میدان در این حالت کمتر خواهد شد

تخلیه از این

محل ممکن است

اتفاق بیفتد

برای همین در اکثر موارد از عایق ترکیبی

می گیرند

نگهدارنده از نوع بالا

- عایق را طوری پرش زده ایم که خطوط میدان سطح جدایی مانند در این حالت روی شدت میدان و خاصیت عایقی تأثیری خواهد گذاشت.

سطوح هم پتانسیل

عایق نگهدارنده

میدان

لیست های GIS پست های فشار قوی در دنیا

برای گاز SF_6 پرشده است قرار دارد.

www.iran-ieee.com

Subject:

Year: Month: Date: ( )

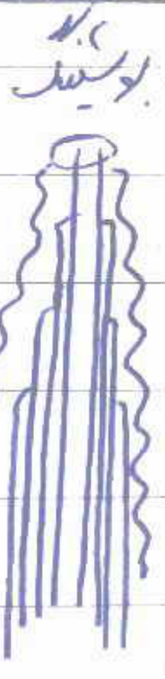
استوانه‌های تودرتو مثل خازن‌های استوانه‌ای سری شده‌اند $C = \epsilon \frac{A}{d}$ ، $A = 2\pi r l$

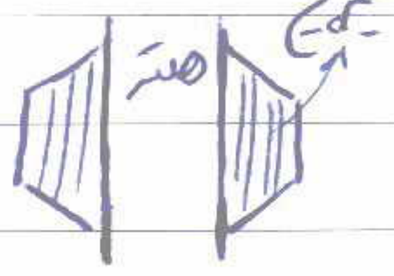
$r \uparrow \; l \downarrow$

کوتاه‌تر طول هر کدام باشد ظرفیت (خازنی) لایه‌های بالایی بیشتر می‌شود ولی اگر طول هر لایه از لایه بالاتر (کم) تودرتو طراحی کنیم بعوری

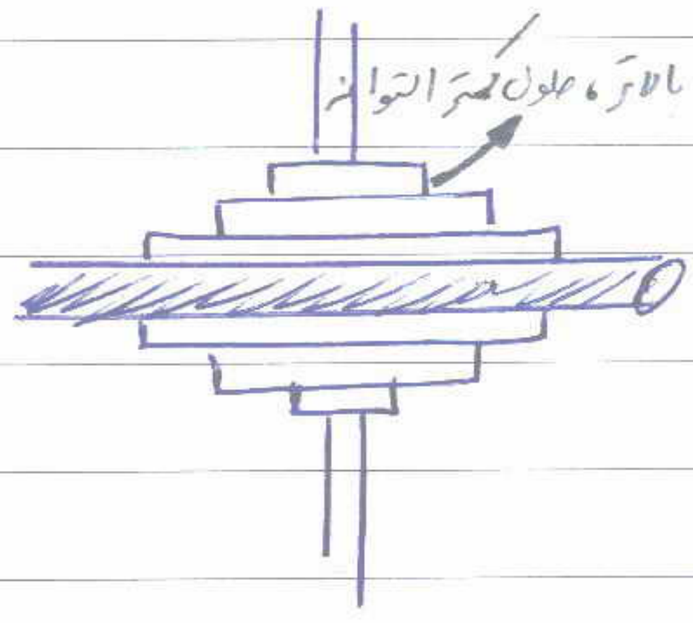
که ظرفیت این خازن‌ها با هم برابر شود خاصیت عایقی بالاتر خواهد شد که در سیم‌های آنتن‌ها و هم جنس بودن شکل آنتن‌ها

از این نکته استفاده شده است و ولتاژ عایقی را مناسب‌تر کرده‌اند.





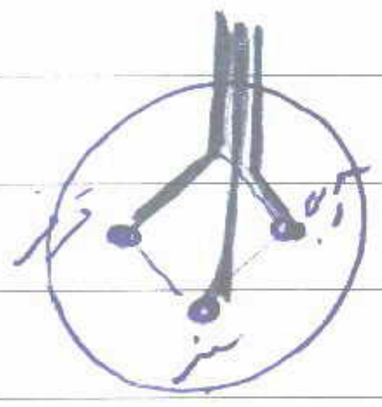
$1 \cdot r_1 l_1 = 1 \cdot r_2 l_2 = \dots$

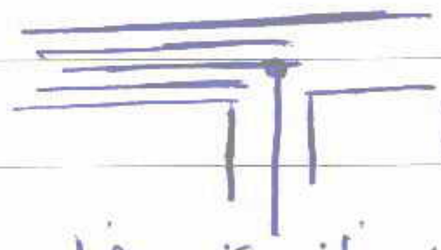


ارتباط‌های GIS:

سرفاز را

جای قرارداد روی سر رأس مثلث روی سر رأس یک سیم‌پیچ قرار می‌دهند.





ارتباط‌گیری‌ها

با این کار فاصله‌ی سه فاز مناسب خواهد بود

صد ۱۷ و ۱۸ هزوه امید

www.iran-ieee.com

Subject: ۱۸

Year: Month: Date: ( )

یک مدار RC است.

ارجاتی که ε_1 و ε_2 صفر نباشد یعنی این دو آن نماینده دیگر $\varepsilon_1 \neq 0$ و $\varepsilon_2 \neq 0$ خواهد بود $\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$

عایق های گازی :

کلمه الکترونگاتیو ها :

هوا، عایق خوبی است.

اگر عایق جامد تحت الکتریکی صورت بگیرد، پیر خراب خواهد شد (سوراخ خواهد شد) ولی در عایق های گازی و مایع نه!

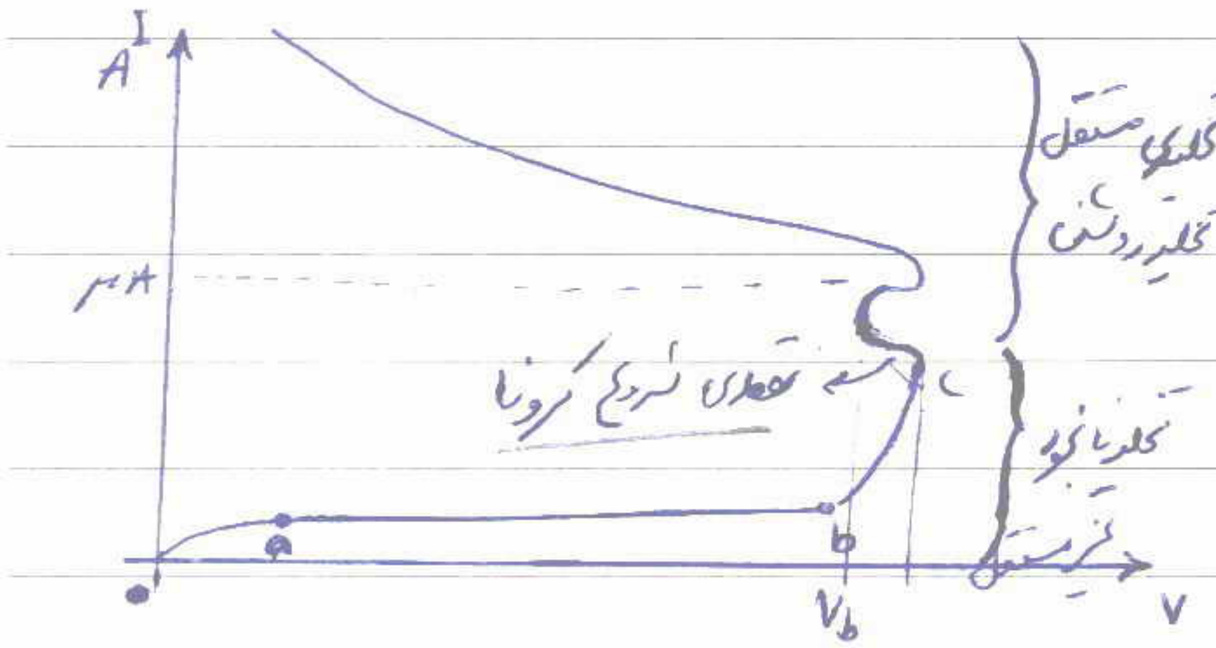
عامل هدایت در فلزات، الکترون های آزاد هستند.

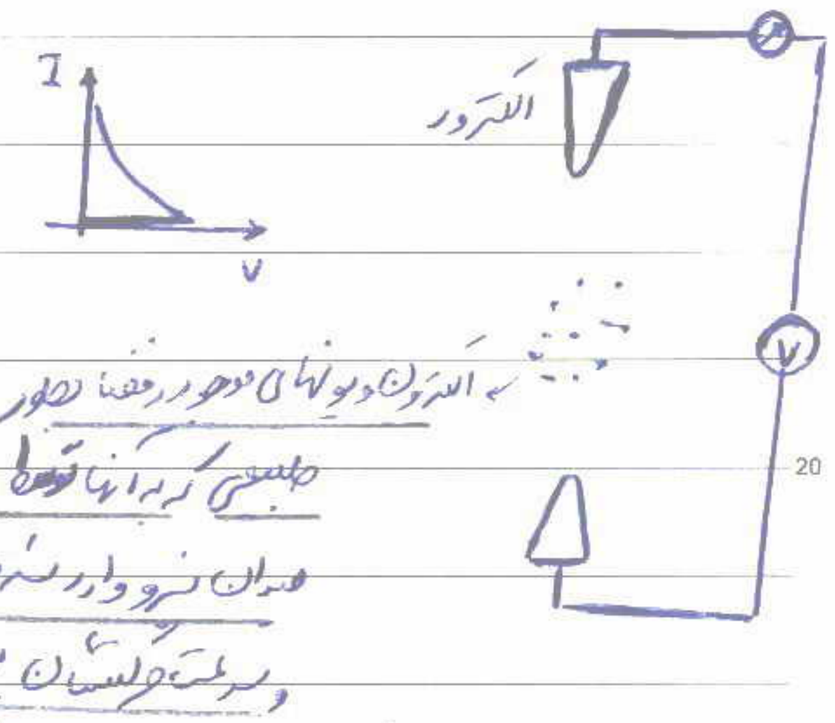
عامل هدایت در محلول ها، اتم ها و یون هایی که یک یا چند الکترون خود را از دست داده اند همچنین الکترون ها

عامل هدایت در گازها، الکترون ها و یون های آزاد شده

عایق خوب: ۱- هدایت الکتریکی آن کم باشد ۲- استقامت الکتریکی آن هم زیاد باشد (هر از دو را)

خلاء هدایت الکتریکی کم هست اما استقامت الکتریکی آن بعد از هوا می شود و همین دلیل هوا از خلاء عایق بهتری است.





* هوا این خاصیت را دارد که از یک حدی به بعد هر چقدر ولتاژ را بالا ببریم تعداد یون و الکترونهای که آزادی شود ثابت خواهد بود و سرعت شان افزایش می یابد و به همین دلیل جریان ثابت می شود.

از ۱ تا ۴: افزایش ولتاژ ← افزایش میدان ← افزایش نیرو ← افزایش سرعت الکترون ها و یون ها که بطور طبیعی در فضا وجود دارند

← یون ها و الکترون ها زمان کمتری برای ترکیب مجدد و خنثی شدن دارند ← افزایش جریان تا اینکه همه الکترون ها و یون های

PARSCO

www.iran-ieee.com

← ولتاژ شکست ـ حجم عایق تحت ولتاژ دارای بستگی دارد

آن در رطوبت با بودن این نوع دارای

Subject: ـ تحرات نیز آب سرعتی های ایده

Year: - Month: Date: ( )

عایق خواهد بود

رشته‌ها جاری در هوا آزاد می‌شوند ـ آند و کاتد می‌رسند.

از a تا b: افزایش ولتاژ تأثیری بر افزایش جریان ندارد. کلیه‌ی الکترون‌ها و یون‌های آزاد شده به الکترودها می‌رسند ✱

از b تا c: افزایش ولتاژ ← افزایش جریان ← افزایش سرعت تا حدی که بعضی از این یون‌ها

5 انرژی کافی برای خارج کردن الکترون از فلز کاتد را پیدا کنند ← افزایش جریان

از c تا d را تخلیه نابخود یا غیر مستقل یا Non-self sustained

Breakdown

10 از نقطه‌ی d به بعد یک افزایش ولتاژ، کاهش ولتاژ را به دنبال دارد ← شکست

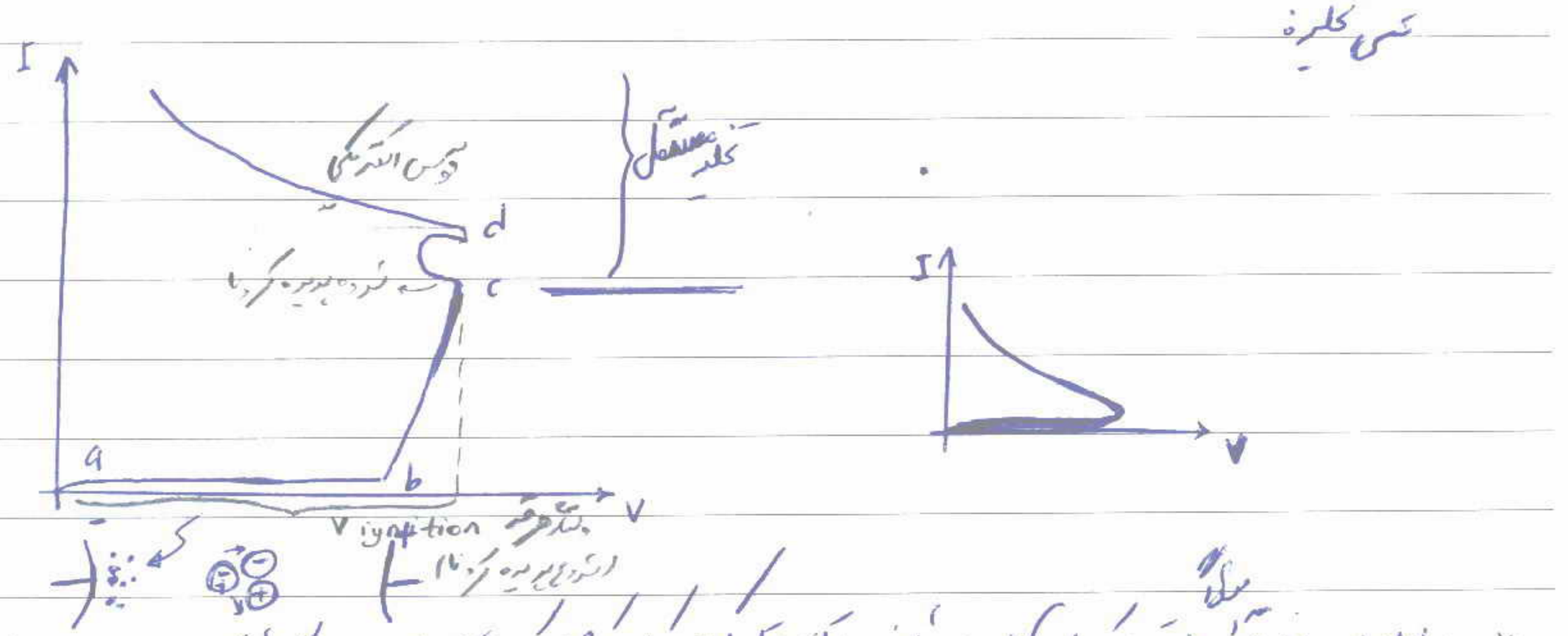
تخلیه مستقل: یعنی اگر الکترون آزاد هم در هوا نداشته باشد تخلیه صورت می‌گیرد.

یا تخلیه روشن

این نوع تخلیه از جایی شروع می‌شود که سرعت الکترون‌های حرکت می‌کنند در برخورد با مولکول‌های گاز هوا به اندازه کافی الکترون آزاد می‌کنند

15

منحنی تخلیه:



20

✱ علت اینکه در حدود ۱۰ تا الکترون آزاد در ثانیه می‌توانند تولید کنند این است که در حدود ۱۰ تا الکترون آزاد در مقدار جریان ندارد

25 چون تمام ۱۰ الکترون را می‌رسانند به الکترودها

PARSCO

ـ روش‌هایی از کابل‌های خاکی آسیب‌های زیادی به آن‌ها وارد کرده‌اند که زمانی خواهد بود و سروصدا خواهد داشت و خسارت‌های زیادی

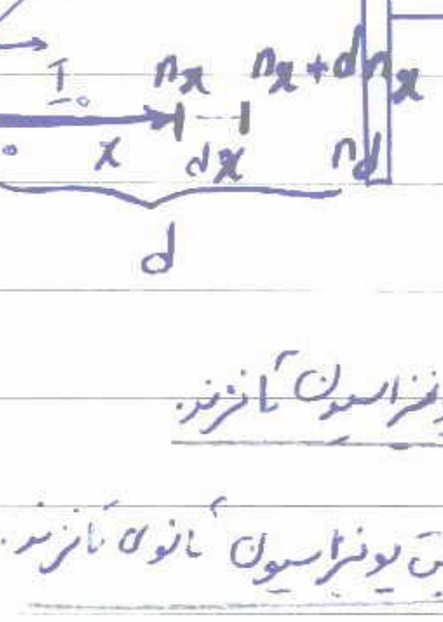
www.iran-ieee.com

Subject: ۱۹

Year: Month: Date: ( )

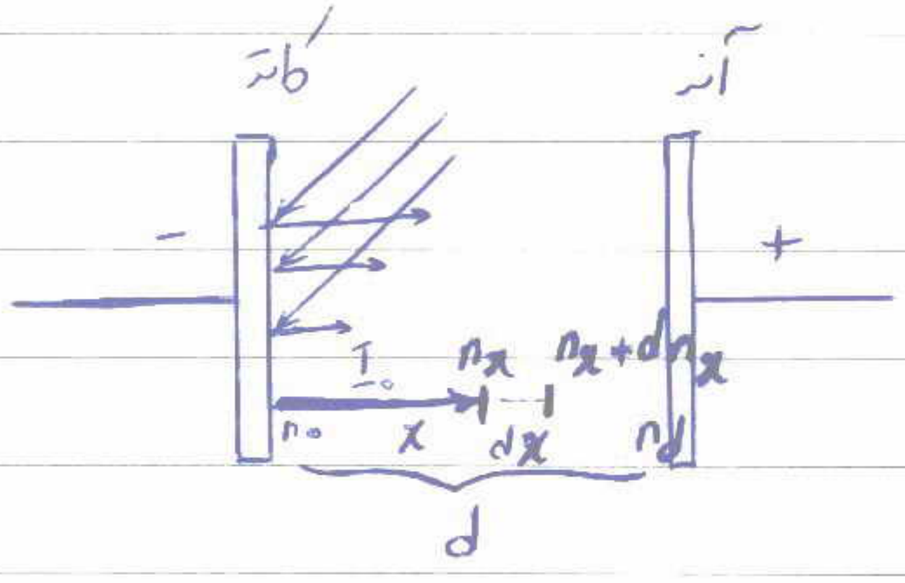
کند الکترون در مسیر حرکت الی آخر بون تولید بلند به

اگر منبع ثابت مقاومت اهمی خیلی زیاد داشته باشد به طوری که اینکه بخواهد جریان زیادی نبود و افت و نزدیکی آن



جریان افت و ولتاژ دو الکترون کم می شود و جریان ثابت می شود.

پس برای اینکه بخواهیم توسط الکترون داشته باشیم باید مقاومت اهمی منبع کم باشد.



α پیکار برخوردهای یونیزه کننده به ازای حرکت یک الکترون

در طول یک سانتی متر مسیر

= اگر یک الکترون یک سانتی متر حرکت کند می شود : α

۲α : " " دو " " " "

اگر دو الکترون یک سانتی متر حرکت کنند می شود : ۲α

= α به E و P بستگی دارد.

S = فاصله متوسط آزاد

فاصله ای که یک الکترون بدون برخورد طی می کند

هرچه E ↑ افزایش یابد ← سرعت حرکت الکترون زیاد می شود ← بالطبع انرژی الکترون هنگام برخورد افزایش می شود ← تعداد برخوردهای یونیزه کننده بیشتر می شود (α ↑)

↑ کاهش زیاد می شود

زمان حضور الکترون در فاصله بدون برخورد کم خواهد بود و فاصله بدون برخورد بیشتر خواهد بود

P فشار زیاد یعنی تراکم ذرات زیاد ← P ↑ بیشتر باشد ← تراکم ذرات بیشتر است ← فاصله متوسط آزاد که الکترون ها طی خواهد بود (S ↓) کمتر خواهد بود

احتمال برخورد با ذرات رابطه مستقیم دارد

$$\alpha = P_{x}f\left(\frac{E}{P}\right)$$

تأثیر پذیرفتن E و P عکس هم است.

PARSCO

www.iran-ieee.com

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$\alpha = P \times f\left(\frac{E}{P}\right)$$

$$\frac{\alpha}{P} = f\left(\frac{E}{P}\right)$$

$\frac{n_x}{n_0}$: تعداد الکترون در فاصله x از کاتد / تعداد الکترون آزاد

تعداد برخورد‌هایی که منجر به تولید یک جفت الکترون - یون می‌شود

$$dn_x = n_x \cdot \alpha \cdot dx \longrightarrow \int_{n_0}^{n_x} \frac{dn_x}{n_x} = \int_0^x \alpha\, dx \longrightarrow \ln\frac{n_x}{n_0} = \alpha x$$

$$\frac{n_x}{n_0} = e^{\alpha x} \leftarrow e^{\ln\frac{n_x}{n_0}} = e^{\alpha x}$$

$$n_x = n_0 e^{\alpha x}$$

$x = d$

$$n_d = n_0 e^{\alpha d}$$

تعداد الکترون‌هایی که از فاصله d آزاد می‌شوند

تعداد الکترون‌هایی که ایجاد شده‌اند

$$\frac{n_d - n_0}{n_0} = \frac{n_0 e^{\alpha d} - n_0}{n_0} = e^{\alpha d} - 1$$

یا تعداد الکترون‌های آزاد نسبی

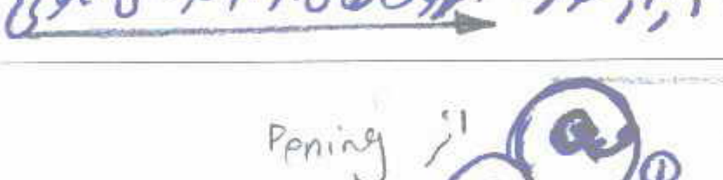
تناقض با قوانین مداری

$$n_d = n_0 e^{\alpha d} \longrightarrow I_d = I_0 e^{\alpha d}$$

جریان ناشی از الکترون‌ها در $x=0$ هست I_0

$I_d > I_0$ و در $x=d$ هست I_d که I_d از I_0 بزرگتر است که این به این طریق ممکن است که یون‌های مثبتی که تولید می‌شوند به سمت کاتد حرکت کرده

که جمع جریان‌های این جریان‌ها صفر خواهد بود.



Secondary Process

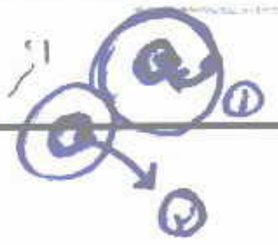
پروسه ثانویه:

γ_1 (i) یون‌های مثبت ممکن است انرژی کافی برای آزاد کردن الکترون داشته باشند / یون‌های آزاد شده در مسیر حرکت هم ممکن است برخورد آزاد کننده داشته باشند

γ_2 (ii) اتم‌های تحریک شده در اثر خنثی یونیزاسیون ممکن است الکترون آزاد کنند

γ_3 (iii) زمان ناپایدار ممکن است انرژی آزاد کننده و در نتیجه الکترون آزاد شود. الکترون‌های آزاد شده ثانویه

Penning از



$f(E,P) \rightsquigarrow \gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$

www.iran-ieee.com

Subject: ۲۰

Year: Month: Date: ( )

تعداد الکترون های آزاد شده در مرحله اولیه یا الکترون های آزاد ثانوی

$n'' = n_0 + n_0'$

تعداد کل الکترون های سکاری در کاتد: n''

نظری قریم

تعداد کل الکترون های سکاری که به آندی رسند.

$n = n'' e^{\alpha d} = (n_0 + n_0') e^{\alpha d}$ ①

$n - n''$ = تعداد الکترون های سکاری که به کاتد برمی گردند

$= n - (n_0 + n_0')$

تعداد آزاد شده در مرحله اولیه که به سمت آند حرکت می کنند

برآیند هر الکترون که آزاد شده و در طول مسیر خود با مولکول ها برخورد می کند و برابر الکترون آزاد می شود است:

در مرحله اولیه

$n_0' = \gamma [n - (n_0 + n_0')]$ ②

(این جمله هر الکترون که آزاد شده است چندبار عمل یونیزاسیون انجام می دهد که به آند حرکت کند)

از حذف n_0' بین ① و ②

$n = \frac{n_0 e^{\alpha d}}{1 - \gamma [e^{\alpha d} - 1]}$

رابطه تانزند:

$I = \frac{I_0 e^{\alpha d}}{1 - \gamma (e^{\alpha d} - 1)}$

$1 - \gamma [e^{\alpha d} - 1] = 0$

$1 - \gamma (e^{\alpha d} - 1) \to \infty$

شرط تخلیه تانزند: $\gamma (e^{\alpha d} - 1) \geq 1$

به معنی آن است که هر الکترون آزاد اولیه حداقل یک الکترون آزاد ثانویه آگاه بدون عوامل دیگر از قبیل نور، جریان اولیه وجود جریان برقرار می ماند.

$e^{\alpha d}$ ← آند ← الکترون ها ← کاتد

الکترون می دهد

پس الکترون های آزاد شده $e^{\alpha d} - 1$ تا می شود

که هر الکترون آزاد شده γ تا الکترون ثانویه آزاد می کند

$\gamma (e^{\alpha d} - 1)$

ادامه صفحه:

حال این الکترون ها در مسیر حرکت خود

تا آند با الکترون های ثانویه یا برخورد می کنند

که حال این تعداد الکترون فعال کردیم با الکترون ها

که با مولکول های خارجی برخورد می کنند

که به کاتد برگردند بخاطر عوامل های خارجی

الکترون آزاد می کند که این الکترون ها

ممکن کاملاً به آند برسند.

PARSCO

www.iran-ieee.com

Subject:

Year: Month: Date: ( )

قانون پاشن:

ولتاژ شروع تخلیه تابعی از pd است.

الکترود
ولتاژ × فشار

شرط تخلیه: تعداد الکترون های که در اثر یونش جفت یون ایجاد می شوند باید حداقل یک الکترون باشند

$$\gamma\left[e^{\alpha d}-1\right] \geq 1$$

$$\gamma\left[e^{\alpha d}-1\right]=1 \quad (1)$$

چرا در رابطه α ، P نداریم؟ گاما

$$\frac{\alpha}{P}=f_1\left(\frac{E}{P}\right) \longrightarrow \alpha = P f_1\left(\frac{E}{P}\right) \quad (2)$$

چون γ خودش از α مشتق می شود $\gamma = f_2\left(\frac{E}{P}\right)$ (3)

وجود P در α کاهش داده است

$$E=\frac{V}{d}$$

(1),(2),(3) $\longrightarrow f_2\left(\frac{E}{P}\right)\left[e^{Pd\, f_1\left(\frac{E}{P}\right)}-1\right]=1$

$$f_2\left(\frac{V}{Pd}\right)\left[e^{Pd\, f_1\left(\frac{V}{Pd}\right)}-1\right]=1$$

حل

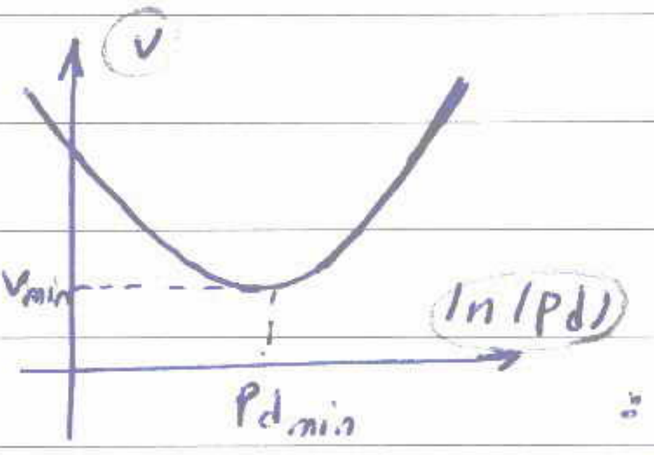
V تابعی از حاصلضرب (وقتی شروع تخلیه)

رابطه ی بین V و pd

d فاصله ی بین دو الکترود

P فشار

$V = f(pd)$



تعبیر فیزیکی برای شرایط $Pd < Pd_{min}$:

یا P کوچک است ← فشار کم شده است ← تعداد مولکول ها کم می شود ← احتمال برخورد کم می شود

یا d کوچک است ← فاصله کم شده است ← مسیری که الکترون ها می پیمایند کم می شود ← احتمال برخورد کم می شود

پس ولتاژ شکست افزایش می یابد

تعبیر فیزیکی برای شرایط $Pd > Pd_{min}$:

یا P بزرگ است ← فشار زیاد شده است ← آنقدر فاصله ی مولکول ها کم می شود که الکترون ها برخورد های آنچنانی ای ندارند یونیزاسیون ندارند یعنی قبل از این که سرعت بگیرند برخورد می کنند

یا d بزرگ است ← فاصله زیاد شده است ← احتمال هدر رفت الکترون و یون ها در هوا زیاد می شود

PARSCO

www.iran-ieee.com

Subject: ۲۱

Year: Month: Date: ( )

$$V = 24.22\,d + 6.08\sqrt{d} \longrightarrow E = \frac{V}{d} = 24.22 + \frac{6.08}{\sqrt{d}}$$

$$V = 24.22\left[\frac{293\,Pd}{760\,T}\right] + 6.08\left[\frac{293\,Pd}{760\,T}\right]^{\frac{1}{2}}$$

ولتاژ شکست هوا برای یک سانتی متر $30\ KV/cm$ است.

اگر کاتد گرم شود باعث می شود الکترون راحت تر از سطحش جدا شود.

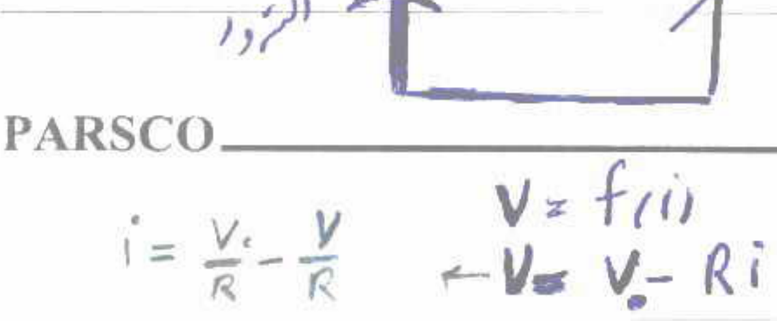
$-273\ ^\circ C$

الکترون ها از سطح کاتد آزاد می شوند البته اگر دمای کاتد از صفر مطلق بیشتر باشد تا این الکترون های آزاد

روی کاتد حفره ایجاد می شود که گذار الکترون های آند به سمت آند فرود دوباره ممکن است حفره های کاتد باز گردند

فرمان جاری شده در پیدایش میدان مغناطیسی ایجاد می کند که این میدان نیروی

بر سمت خارج وارد می کند و حجم کل جرم ها حیل پراکنده و باز شدن راه بند



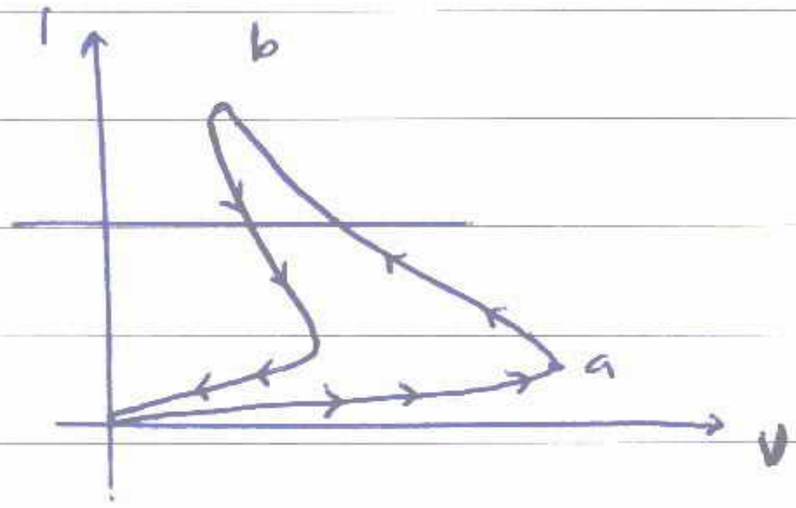
جاهایی که نخواهند استقامت الکتریکی را افزایش دهند

فشار را افزایش می دهند تا کاهش حجم تجهیزات پست های GIS.

PARSCO
www.iran-ieee.com

شکست رفتار پاشن قوس:

اگر آرام ولتاژ را کاهش دهیم روی همان مسیر رفت برگشت می‌کردیم ولی اگر سریع و نامنظم ولتاژ را کاهش دهیم روی مسیر دیگری برمی‌گردیم



یا می‌توان گفت در گذشت یون جسم گرم شده است

یا نیاز گرمایی مورد نیاز است.

اثر Penning : وقتی مقدار کمی نئون در آرگون بریزیم باعث آزاد شدن الکترون های آرگون خواهد شد.

آرگون ← حداقل پتانسیل یونیزاسیون آن $15.7\ ev$ است.

نئون ← کوچکترین سطح پایدار نئون $16.7\ ev$ انرژی دارد.

حد پایین $16.7\ ev$ انرژی آزادی گذر

انرژی پتانسیل یونیزاسیون کوچکترین سطح پایدار نئون

وقتی مقدار کمی نئون در آرگون بریزیم باعث آزاد شدن الکترون های آرگون خواهد شد.

استفاده اکثر تکنیک مخلوط این دو از هر روی آنها بهتر است و گاز نون با شن هم برای شکست تفاوتی نیست.

www.iran-ieee.com

Subject: تداومی یون باعث می شود این نوک تیزکمی پخ تر شود یعنی نه طور باید و شدت میدان کمتر شود و این باعث

Year: ۲۲ Month: Date: ( )

کرونا: کرونای مثبت | + | یون ها | الکترون سوزنی شکل منفی باشد و از این حالت شکست الکتریکی

زیرتر از حالت کرونای مثبت رخ می دهد.

کرونای منفی | − | الکترونها

بیشتر اتفاقاتی ها ثبت شده در حضور اتفاق در نیم سیکل کیبت است به همین دلیل بالا بودن الکترون منفی کرونای مثبت کمتر است

کرونای منفی: بصورت جرقه های پالسی Trichel Pulses می باشد و نور آن تقریباً متمایل به قرمز است.

کرونای مثبت: بصورت نور سفید رنگ پیوسته مشاهده می شود

در کرونای AC: یک جزئی بین سفید و قرمز خواهد بود

مزایا و کاربردهای کرونا:

مزایا:

کاربردها: ۱- کابلها که البته تعمیرات و نگهداری آنها سخت خواهد بود (خصوصاً اگر در شیب استفاده شوند)

۲- ترانس قدرت ها و ترانس ها

۳- فیلترهای رطوبتی

۴- هادی ها

معایب:

۱- خاموش کردن قوس الکتریکی در کلیدهای قدرت

۲- خنک کردن

۳- از طریق تزریق رطوبت و ذرات گاز هیدروژن

معمولاً از نقطه بدست می آیند؛ از هیدروژن ها هم می توان رطوبت تولید کرد، از گیاهان هم می توان رطوبت تولید کرد.

در رطوبت های بالا از هیدروژن فلوراستفاده می کنند.

- در رطوبت بالا ... از هیدروژن فلوراید استفاده می کنند

رطوبت مهمترین عامل خرابی سالاتی دارد.

www.iran-ieee.com

ابتدا و انتها باید در حرز جمع شود پس اختلاف پتانسیل قرینه کاتد بیشتر خواهد شد و این ادامه خواهد
Subject:
Year: Month: Date: ( )
راست تا $J_2 = J_1 = J$ ثابت

حضور کمی ناخالصی مانند آب در... می تواند استحکام عایق را کاهش دهد.

خصوصیات مهم عایق مایع:

- مقاومت الکتریکی باید بالا باشد.

- ثابت دی الکتریک هرچی بزرگتر باشد عایق بهتری هم نزدیک‌تر هم باشد.

- استحکام دی الکتریکی باید زیاد باشد.

- ویسکوزیته باید زیاد باشد (روانکاری) ولی در کابل‌ها باید کم باشد

- پایداری شیمیایی باید زیاد باشد. - خواص شیمیایی - پایداری شیمیایی - پایداری حرارتی - ویسکوزیته (مقاومت) - ... - خصوص

- پایداری حرارتی باید زیاد باشد

- وزن مخصوص باید کم باشد. - عاری از ناخالصی باشد

- گرانی - کاربردهای متعدد

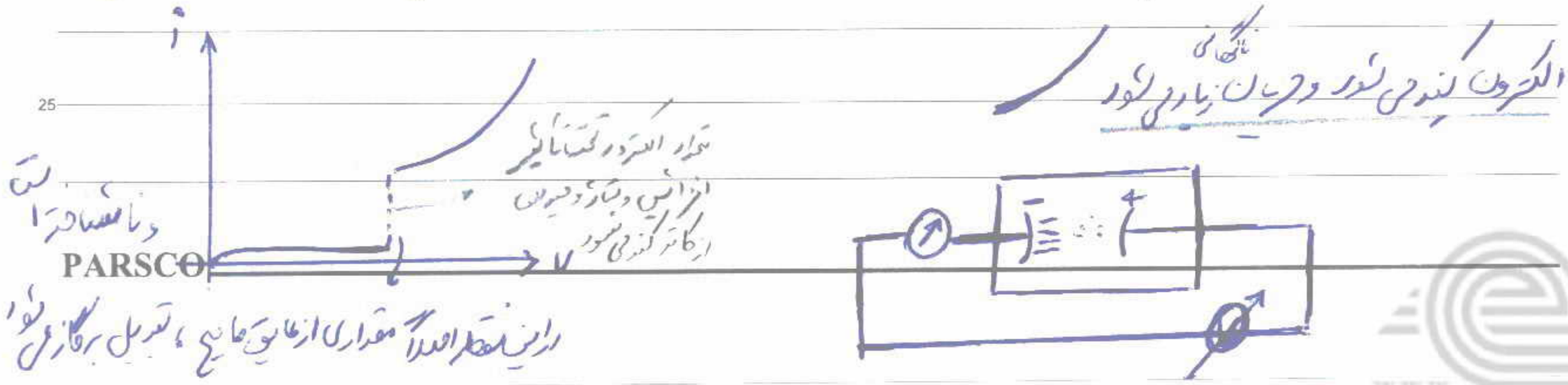
مهمترین عایق مایع، پارافین است

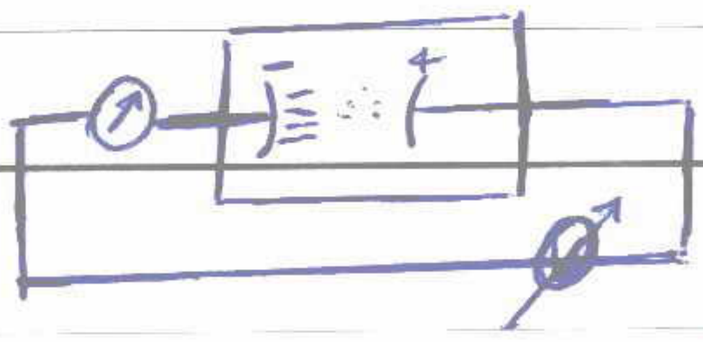
- خصوصیات عایق مایع و حالت در مقابل عایق های گازی مقداری ناشناخته است چون عایق گازی می‌توان همواره در نظر

در آن خلیه ای ایجاد کرد ولی روی عایق جامد با انجام تخلیه از بین نخواهد رفت و عایق مایع هم در هر تخلیه ناخالصی های آن از بین

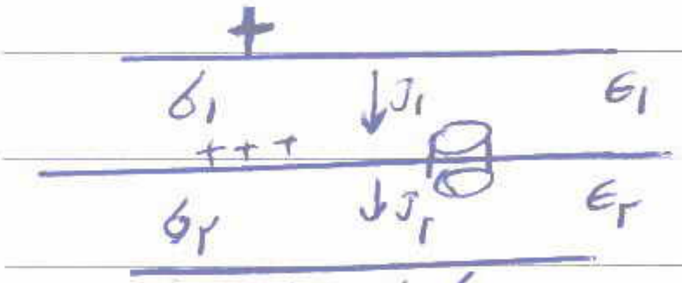
- در عایق های مایع الکترون بوجود آمده مولکول های عایق اندکی هدایت می شوند اما بعد از ایجاد سطح و تقارن ناگهانی از مقداری

الکترون کنده می شود و جریان زیاد می شود





در این نقطه ناگهان مقداری از عایق مایع به تبدیل به گاز می شود



به شرطی جریان عبور می کند که مقاومت الکتریکی آن کماکان ثابت باشد.

$\oint D\,ds = \Sigma q = 0$

$(\epsilon_1 E_1 - \epsilon_2 E_2) S = 0$

$\left(\frac{E_1}{E_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\right)$

$J_1^{\infty} = J_2^{\infty}$

$\sigma_1 \vec{E_1} = \sigma_2 \vec{E_2}$ برای DC از همان شرط

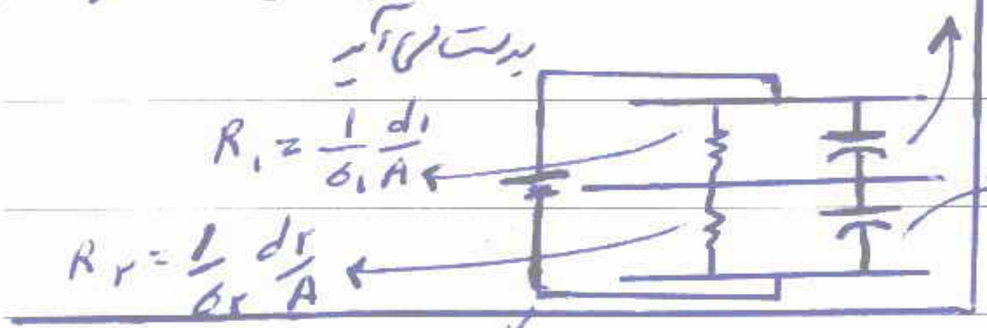
$\left(\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)$ حیان در بین نهایت حاصل می شود:

برای بدست آوردن رابطه جهانی

یک مدار RC است که اگر در مقدار $t = 0$

آن این زمان t را بگذاریم این مقدارها

$C_1 = \epsilon_1 \frac{A}{d_1}$



- کاربردهای متعدد

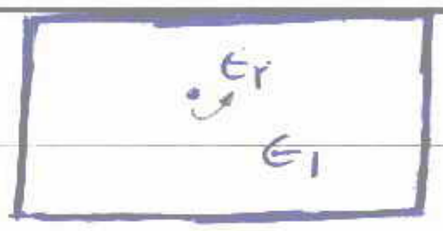
مهمترین مصرف، پارافین است، پایداری شیمیایی آن

Subject: ۲۳

Year: Month: Date: ( )

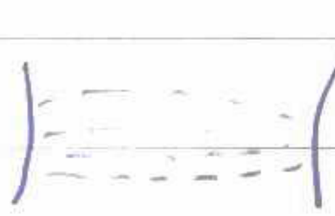
یکی از تئوری های کربیان می شود

الف) تئوری زوات معلق در مایع :



چون ضریب ای الکتریک ذره با مایع متفاوت است میدان در اطراف ذره تغییر خواهد کرد و ذره نیرو وارد خواهد شد.

ذرات پراکنده ای نیستند بلکه تشکل می گیرند و کلنی را تشکیل می دهند



و ممکن کلنی در این حالت ایجاد شود اگر هوادیت ذرات از هوادیت مایع بیشتر باشد

$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ باشد نیرو در سمت شدت میدان قوی تر است.

$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ باشد " " " ضعیف تر است.

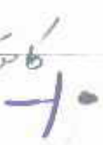
(توجه جزوه) $f \approx \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + 2\varepsilon_1} E \operatorname{grad} E$

ب) تئوری حباب های هوا در گاز

شدت میدان در اطراف ذره زیاد خواهد شد و تخلیه ایجاد می شود

از تجزیه و تحلیل هم تجزیه شده و گاز تولید می شود

ج) تئوری حجم مایع تحت فشار الکتریکی



ضربه هم است که از جنبه رسانه مایع شدت میدان ماکزیمم وجود دارد

و راهی که حجم مایعی که شدت میدان در آن زیاد است با ایجاد تخلیه زودتر صورت می گیرد.

$E_{max} \sim E_{max}$ شدت میدان ماکزیمم

- عبارت است از تصور مایعی که شدت میدان در آن از ۰/۹ E_{max} تا E_{max} : تعریف حجم مایع تحت فشار

از ۰/۹ شدت میدان ماکزیمم بیشتر است

و فشار شکست بطور معکوس مساحت حجم مایع تحت فشار الکتریکی

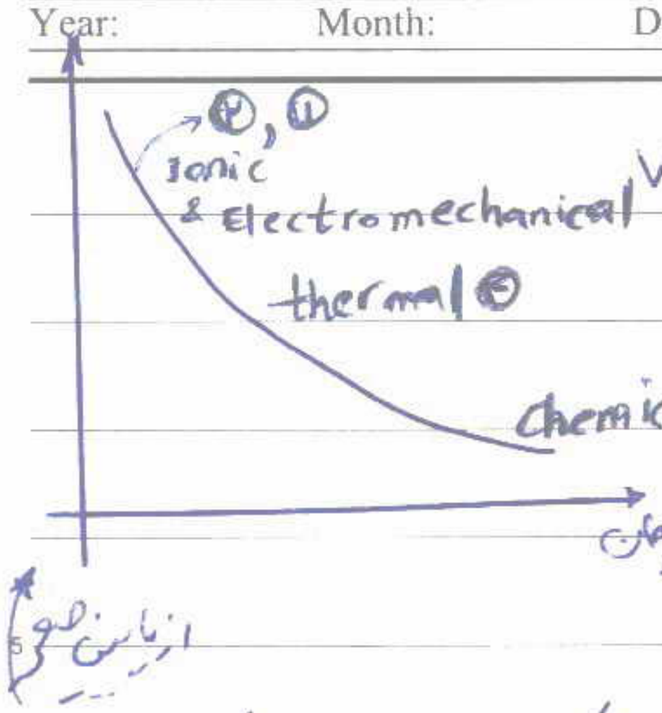
- گرمایی که در اثر افزایش شدت جریان ایجاد شده است نیز نقش دارد.

PARSCO

www.iran-ieee.com

Subject:

Year: Month: Date: ( )



کوچکتر از ۱

$V = A\, d^{n}$

ثابت — فاصله دو الکترود

نکات مهم:

۱- رابطه ولتاژ شکست و فاصله‌ی دو الکترود خطی نیست

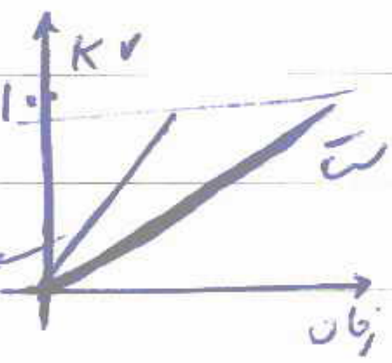
۲- ولتاژ شکست به شکل الکترود بستگی دارد.

۳- شکل فاز هم روی ولتاژ شکست تأثیر دارد.

ولتاژ شکست DC > ولتاژ شکست AC > ولتاژ شکست ضربه

چون بالا رفتن از صفر زمان نیاز دارد

۴- سرعت بالا رفتن ولتاژ بر شکست موثر است



- اگر سرعت افزایش ولتاژ به اندازه کافی زیاد نباشد ولتاژ کمتری رخ می دهد

۵- هیچ یک از کاغذ و رسم بالا نشان می دهد استقامت عایق فاقد زمان بودن چون هیچ مقدار زیادی از ولتاژ شکست را تحمل می کند.

عایق‌های جامد:

اگر شکست الکتریکی از عایق جامد اتفاق بیافتد از این جامد زیست ول عایق مایع تبخیر شده و عایق گازی ۱۰۰ برابر به جای آن برقرار می گردد.

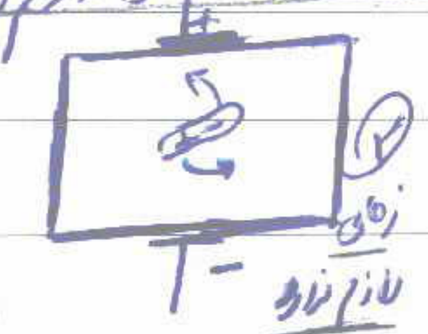
عایق جامد خوب باید: ۱- استقامت مکانیکی بالایی داشته باشد ۲- تلفات دی الکتریکی کم ۳- خالص بودن

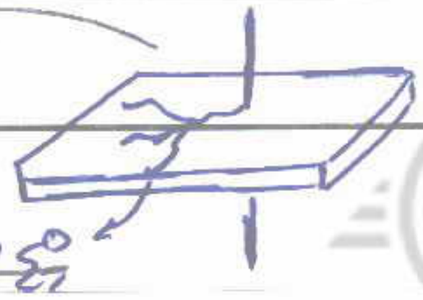
۴- ولتاژ مخصوص کم

۱- مکانیزم های شکست الکتریکی در عایق های جامد: ۱- Ionic یا intrinsic

۲- Electromechanical ۳- شکست ریلی ۴- Tracking & treeing شکست حرارتی ۵- شکست شیمیایی

۶- شکست تخلیه جزئی داخلی





PARSCO
www.iran-ieee.com